

TLV900x-Q1、低消費電力、RRIO、1MHz 車載用オペアンプ

1 特長

- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
 - 温度グレード 1: -40°C ~ +125°C, T_A
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 低コスト アプリケーション向けのスケーラブルな CMOS アンプ
- レール ツー レール 入出力
- 低い入力オフセット電圧: ±0.4mV
- ユニティ ゲイン 帯域幅: 1MHz
- 低い広帯域ノイズ: 27nV/√Hz
- 低い入力バイアス電流: 5pA
- 低い静止電流: 60μA/Ch
- ユニティ ゲイン 安定
- 内部 RFI および EMI フィルタ
- 最低 1.8V の電源電圧で動作
- 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
- 機能安全対応
 - 機能安全の情報

2 アプリケーション

- AEC-Q100 グレード 1 機器に対して最適化
- インフォテインメントおよびクラスタ
- パッシブ型安全運転支援システム
- 車体エレクトロニクスおよび照明
- HEV/EV のインバータおよびモータ制御
- オンボード充電器 (OBC) およびワイヤレス充電器
- パワートレイン電流センサ
- 先進運転支援システム (ADAS)
- 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路

3 説明

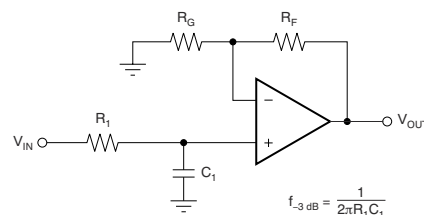
TLV900x-Q1 ファミリーには、低電圧 (1.8V ~ 5.5V) でレール ツー レール 入出力スイング能力を備えた、シングル (TLV9001-Q1)、デュアル (TLV9002-Q1) およびクワッド (TLV9004-Q1) チャンネルのオペアンプがあります。これらのオペアンプは、低電圧動作と大容量負荷駆動が必要なインフォテインメントおよび照明などのスペース制約が厳しい車載アプリケーション向けに、コスト効率の優れたオプションを提供します。TLV900x-Q1 ファミリーの容量性負荷の駆動能力は 500pF であり、オープン ループ 出力インピーダンスが抵抗性なので、はるかに大きな容量性負荷についても容易に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V ~ 5.5V) で動作し、TLV600x-Q1 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV900x-Q1 ファミリーは堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプは、ユニティ ゲイン 安定性、RFI および EMI 除去フィルタ内蔵、およびオーバードライブ状態で位相反転がない、といった特長があります。

パッケージ情報

型番 ⁽¹⁾	パッケージ ⁽²⁾	本体サイズ (公称)
TLV9001-Q1	DBV (SOT-23, 5)	1.60mm × 2.90mm
	DCK (SC70, 5)	1.25mm × 2.00mm
TLV9002-Q1	D (SOIC, 8)	3.91mm × 4.90mm
	PW (TSSOP, 8)	3.00mm × 4.40mm
	DGK (VSSOP, 8)	3.00mm × 3.00mm
TLV9004-Q1	DYY (SOT-23, 14)	4.20mm × 1.90mm
	D (SOIC, 14)	8.65mm × 3.91mm
	PW (TSSOP, 14)	4.40mm × 5.00mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- 製品比較表を参照してください。



$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right) \left(\frac{1}{1 + sR_1C_1}\right)$$

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

シングル ポールのローパス フィルタ



目次

1 特長.....	1	7.3 機能説明.....	18
2 アプリケーション.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	18
3 説明.....	1	8 アプリケーションと実装.....	19
4 デバイス比較表.....	3	8.1 アプリケーション情報.....	19
5 ピン構成および機能.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	19
6 仕様.....	7	8.3 電源に関する推奨事項.....	23
6.1 絶対最大定格.....	7	8.4 レイアウト.....	24
6.2 ESD 定格.....	7	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	25
6.3 推奨動作条件.....	7	9.1 ドキュメントのサポート.....	25
6.4 シングル チャネルの熱に関する情報.....	7	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	25
6.5 デュアル チャネルの熱に関する情報.....	8	9.3 サポート・リソース.....	25
6.6 クワッド チャネルの熱に関する情報.....	8	9.4 商標.....	25
6.7 電気的特性.....	9	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	25
6.8 代表的特性.....	11	9.6 用語集.....	25
7 詳細説明.....	17	10 改訂履歴.....	26
7.1 概要.....	17	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	27
7.2 機能ブロック図.....	17		

4 デバイス比較表

デバイス	チャネル 数	パッケージ・リード					
		SOT-23 DBV	SC70 DCK	SOIC D	TSSOP PW	VSSOP DGK	SOT-23 DYY
TLV9001-Q1	1	5	5	—	—	—	
TLV9002-Q1	2	—	—	8	8	8	—
TLV9004-Q1	4	—	—	14	14	—	14

5 ピン構成および機能

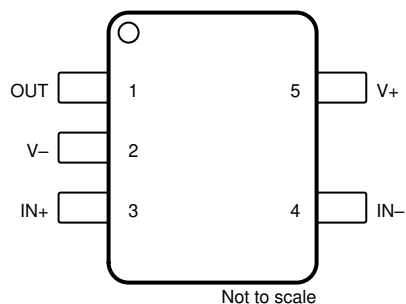


図 5-1. TLV9001-Q1 DBV パッケージ、
5 ピン SOT-23
(上面図)

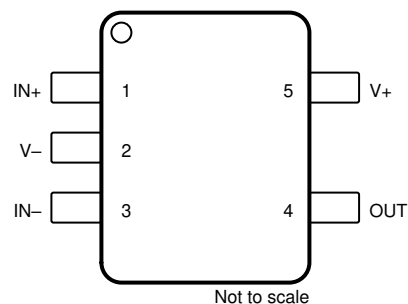
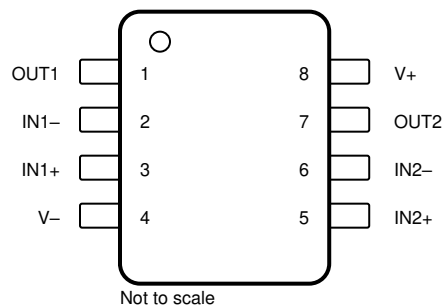


図 5-2. TLV9001-Q1 DCK パッケージ、TLV9001U-Q1
DBV パッケージ、
5 ピン SC70
5 ピン SOT-23 (上面図)

表 5-1. ピンの機能 : TLV9001-Q1

名称	ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
	SOT-23	SC70、SOT-23 (U)		
IN-	4	3	I	反転入力
IN+	3	1	I	非反転入力
OUT	1	4	O	出力
V-	2	2	I または —	負 (低) 電源またはグラウンド (単電源動作の場合)
V+	5	5	I	正 (高) 電源

(1) I = 入力、O = 出力

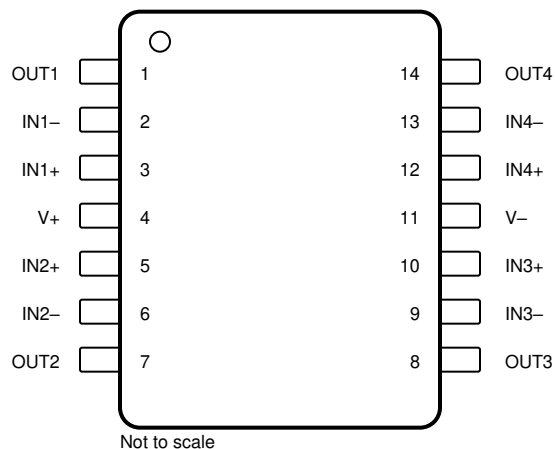


**図 5-3. TLV9002-Q1 D、DGK、PW パッケージ、
8 ピン SOIC、VSSOP、TSSOP
(上面図)**

表 5-2. ピンの機能 : TLV9002-Q1

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
IN1–	2	I	反転入力、チャンネル 1
IN1+	3	I	非反転入力、チャンネル 1
IN2–	6	I	反転入力、チャンネル 2
IN2+	5	I	非反転入力、チャンネル 2
OUT1	1	O	出力、チャンネル 1
OUT2	7	O	出力、チャンネル 2
V–	4	I または —	負 (低) 電源またはグラウンド (単電源動作の場合)
V+	8	I	正 (高) 電源

(1) I = 入力、O = 出力



**図 5-4. TLV9004-Q1 D、PW、DYY パッケージ、
14 ピン SOIC、TSSOP、SOT-23
(上面図)**

表 5-3. ピンの機能 : TLV9004-Q1

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
IN1–	2	I	反転入力、チャンネル 1
IN1+	3	I	非反転入力、チャンネル 1
IN2–	6	I	反転入力、チャンネル 2
IN2+	5	I	非反転入力、チャンネル 2
IN3–	9	I	反転入力、チャンネル 3
IN3+	10	I	非反転入力、チャンネル 3
IN4–	13	I	反転入力、チャンネル 4
IN4+	12	I	非反転入力、チャンネル 4
NC	—	—	内部接続なし
OUT1	1	O	出力、チャンネル 1
OUT2	7	O	出力、チャンネル 2
OUT3	8	O	出力、チャンネル 3
OUT4	14	O	出力、チャンネル 4
V–	11	I または —	負 (低) 電源またはグラウンド (単電源動作の場合)
V+	4	I	正 (高) 電源

(1) I = 入力、O = 出力

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
電源電圧 ([V+] - [V-])			0	6	V
信号入力ピン	電圧 ⁽²⁾	同相	(V-) - 0.5	(V+) + 0.5	V
		差動 ⁽⁴⁾	(V+) - (V-) + 0.2		V
	電流 ⁽²⁾		-10	10	mA
出力短絡 ⁽³⁾			連続		mA
動作温度、T _A			-55	150	°C
接合部、T _J				150	°C
保存、T _{stg}			-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス定格であり、推奨動作条件に示されている条件を超える当該の条件またはその他のいかなる条件下での、デバイスの正常な動作を保証するものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を及ぼす場合があります。
- (2) 入力ピンは、電源レールに対してダイオード クランプされています。入力信号のスイングが 0.5V 以上電源レールを超える場合は、電流を 10mA 以下に制限する必要があります。
- (3) グランドへの短絡、パッケージあたり 1 台のアンプ。
- (4) 0.5V を超える差動入力電圧が連続的に印加されると、入力オフセット電圧と静止電流がこれらのパラメータの最大仕様を上回ってシフトする可能性があります。動作時の周囲温度が高いときほど、その影響が大きくなります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 準拠 ⁽¹⁾	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠	±1000	

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
V _S	電源電圧	1.8	5.5	V
T _A	規定温度	-40	125	°C

6.4 シングル チャネルの熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TLV9001-Q1		単位
		DBV (SOT-23)	DCK (SC70)	
		5 ピン	5 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	232.5	239.6	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	131.0	148.5	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	99.6	82.3	°C/W
ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	66.5	54.5	°C/W
ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	99.1	81.8	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

6.5 デュアル チャネルの熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TLV9002-Q1			単位
		D (SOIC)	DGK (VSSOP)	PW (TSSOP)	
		8 ピン	8 ピン	8 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	151.9	196.6	180.1	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	92.0	86.2	84.4	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	95.4	118.3	120.2	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	40.2	23.2	15.3	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	94.7	116.7	117.6	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、「[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)」アプリケーション ノートを参照してください。

6.6 クワッド チャネルの熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TLV9004-Q1			単位
		D (SOIC)	DYY (SOT-23)	PW (TSSOP)	
		14 ピン	14 ピン	14 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	115.1	154.3	135.3	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	71.2	86.8	63.5	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	71.1	67.9	78.4	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	29.6	10.1	13.6	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	70.7	67.5	77.9	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

6.7 電気的特性

$V_S = (V+) - (V-) = 1.8V \sim 5.5V (\pm 0.9V \sim \pm 2.75V)$, $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 10k\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$ の場合 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
オフセット電圧						
V _{OS}	入力オフセット電圧	V _S = 5 V		±0.4	±1.85	mV
		V _S = 5V、T _A = -40°C～125°C			±2	mV
dV _{OS} /dT	V _{OS} と温度との関係	T _A = -40°C～125°C		±0.6		μV/°C
PSRR	電源除去比	V _S = 1.8V ～ 5.5V、V _{CM} = (V-)	80	105		dB
入力電圧範囲						
V _{CM}	同相電圧範囲	位相反転なし、レール ツー レール入力	(V-) - 0.1		(V+) + 0.1	V
CMRR	同相除去比	V _S = 1.8V、(V-) - 0.1V < V _{CM} < (V+) - 1.4V、 T _A = -40°C～125°C		86		dB
		V _S = 5.5V、(V-) - 0.1V < V _{CM} < (V+) - 1.4V、 T _A = -40°C～125°C		95		dB
		V _S = 5.5V、(V-) - 0.1V < V _{CM} < (V+) + 0.1V、 T _A = -40°C～125°C	63	77		dB
		V _S = 1.8V、(V-) - 0.1V < V _{CM} < (V+) + 0.1V、 T _A = -40°C～125°C		68		dB
入力バイアス電流						
I _B	入力バイアス電流	V _S = 5 V		±5		pA
I _{OS}	入力オフセット電流			±2		pA
ノイズ						
E _n	入力電圧ノイズ (ピーク ツー ピーク)	f = 0.1Hz～10Hz、V _S = 5V		4.7		μV _{PP}
e _n	入力電圧ノイズ密度	f = 1kHz、V _S = 5V		30		nV/√Hz
		f = 10kHz、V _S = 5V		27		nV/√Hz
i _n	入力電流ノイズ密度	f = 1kHz、V _S = 5V		23		fA/√Hz
入力容量						
C _{ID}	差動			1.5		pF
C _{IC}	同相			5		pF
開ループ ゲイン						
A _{OL}	開ループ電圧ゲイン	V _S = 5.5V、(V-) + 0.05V < V _O < (V+) - 0.05V、 R _L = 10kΩ	104	117		dB
		V _S = 1.8V、(V-) + 0.04V < V _O < (V+) - 0.04V、 R _L = 10kΩ		100		dB
		V _S = 1.8V、(V-) + 0.1V < V _O < (V+) - 0.1V、 R _L = 2kΩ		115		dB
		V _S = 5.5V、(V-) + 0.15V < V _O < (V+) - 0.15V、 R _L = 2kΩ		130		dB
周波数応答						
GBW	ゲイン帯域幅積	V _S = 5 V		1		MHz
φ _m	位相マージン	V _S = 5.5V、G = 1		78		度
SR	スルー レート	V _S = 5 V		2		V/μs
t _S	セトリング時間	0.1% まで、V _S = 5V、2V ステップ、G = +1、C _L = 100pF		2.5		μs
		0.01% まで、V _S = 5V、2V ステップ、G = +1、C _L = 100pF		3		μs
t _{OR}	過負荷回復時間	V _S = 5V、V _{IN} × ゲイン > V _S		0.85		μs
THD+N	全高調波歪み + ノイズ	V _S = 5.5V、V _{CM} = 2.5V、V _O = 1V _{RMS} 、G = +1、 f = 1kHz、80kHz の測定帯域幅		0.004		%
出力						
V _O	電源レールからの電圧出力スイング	V _S = 5.5V、R _L = 10kΩ		10	20	mV
		V _S = 5.5V、R _L = 2kΩ		35	55	mV

6.7 電気的特性 (続き)

$V_S = (V+) - (V-) = 1.8V \sim 5.5V (\pm 0.9V \sim \pm 2.75V)$ 、 $T_A = 25^\circ C$ 、 $R_L = 10k\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$ の場合 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I_{SC}	短絡電流	$V_S = 5.5V$		± 40		mA
Z_O	オープン ループ出力インピーダンス	$V_S = 5V$, $f = 1MHz$		1200		Ω
電源						
V_S	規定電圧範囲		1.8 (± 0.9)		5.5 (± 2.75)	V
I_Q	アンプごとの静止電流	$I_O = 0mA$, $V_S = 5.5V$		60	80	μA
		$I_O = 0mA$, $V_S = 5.5V$, TLV9002RQDGKRQ1		60	85	μA
		$I_O = 0mA$, $V_S = 5.5V$, $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$			85	μA
	パワーオン時間	$V_S = 0V \sim 5V$ から I_Q レベルの 90% まで		50		μs

6.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 2.75\text{V}$, $V_- = -2.75\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (特に記述のない限り)

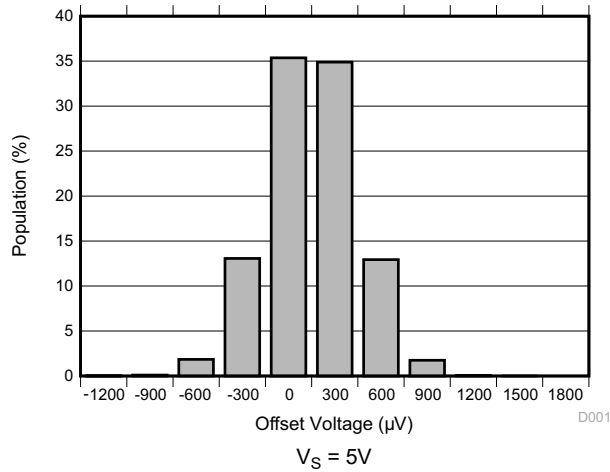


図 6-1. オフセット電圧の分布ヒストグラム

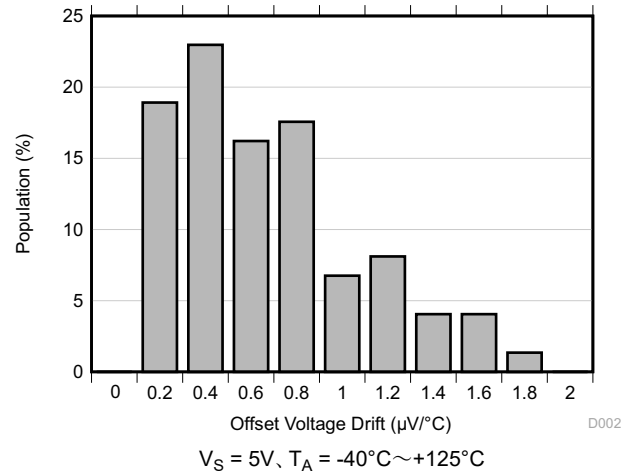


図 6-2. オフセット電圧ドリフトの分布ヒストグラム

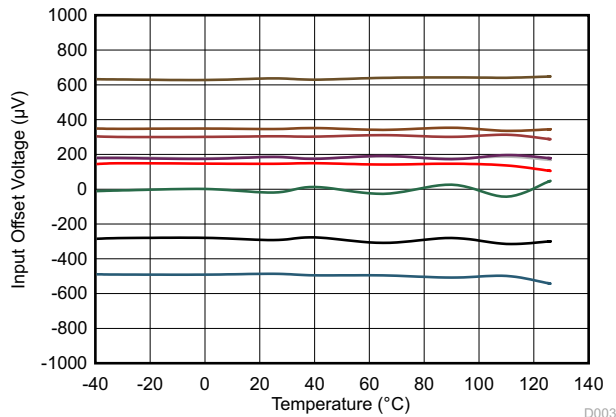


図 6-3. 入力オフセット電圧と温度との関係

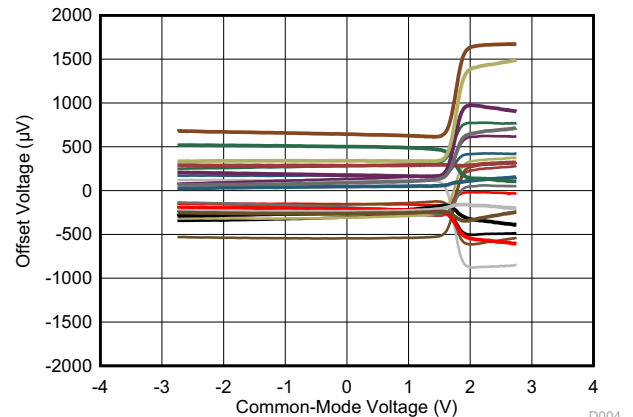


図 6-4. オフセット電圧と同相電圧との関係

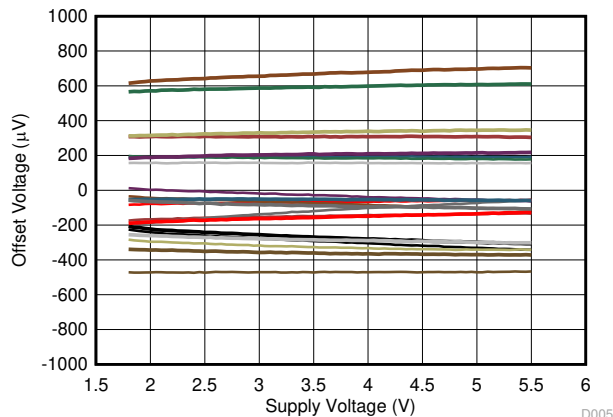


図 6-5. オフセット電圧と電源電圧との関係

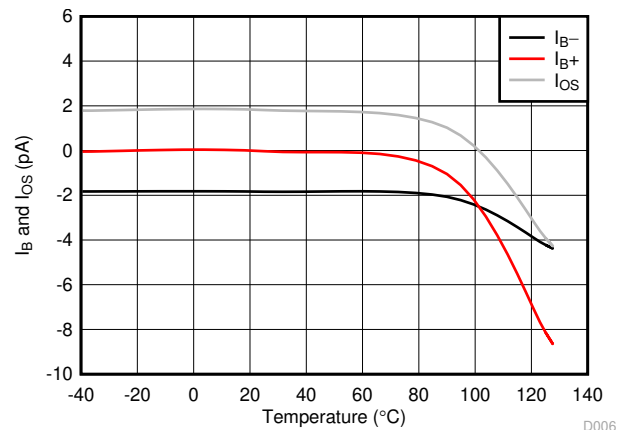


図 6-6. I_B および I_{OS} と温度との関係

6.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 2.75\text{V}$, $V_- = -2.75\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (特に記述のない限り)

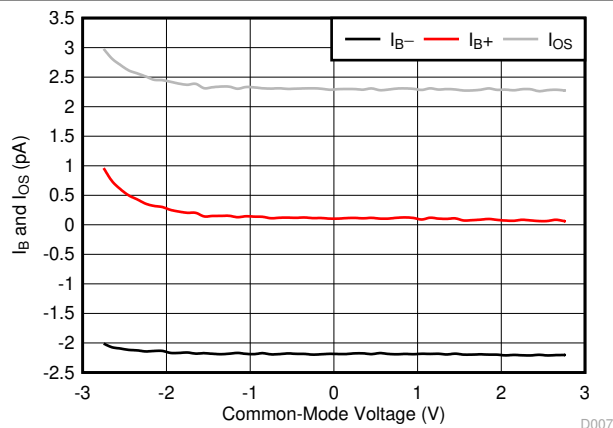


図 6-7. I_B および I_{OS} と同相電圧との関係

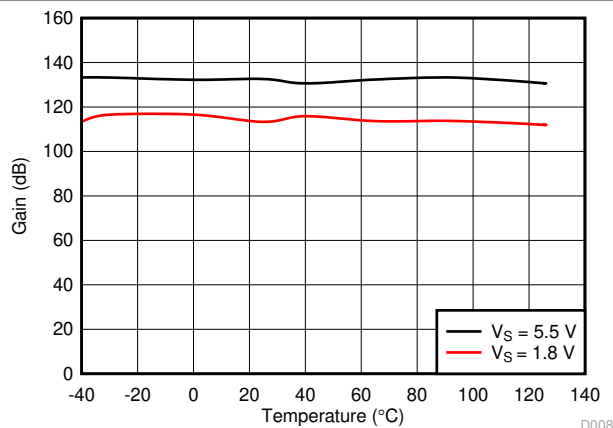


図 6-8. 開ループゲインと温度との関係

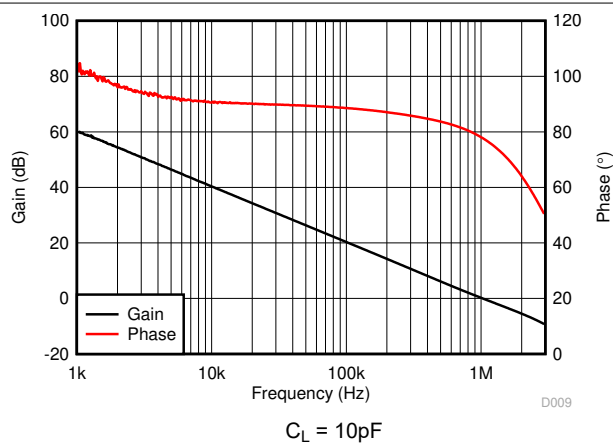


図 6-9. 開ループゲインおよび位相と周波数との関係

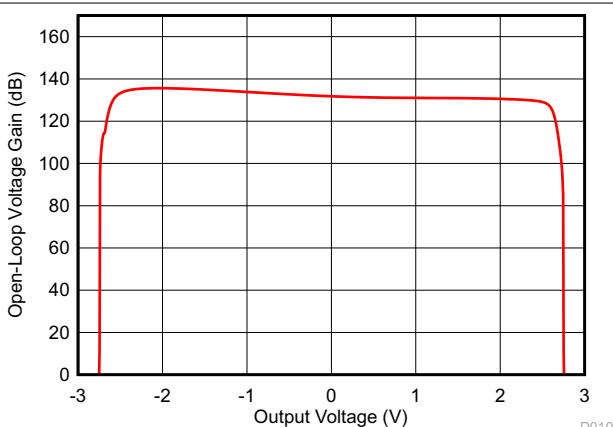


図 6-10. 開ループゲインと出力電圧との関係

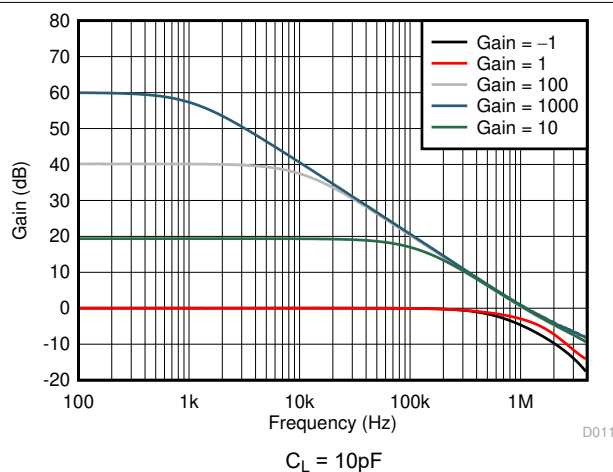


図 6-11. 開ループゲインと周波数との関係

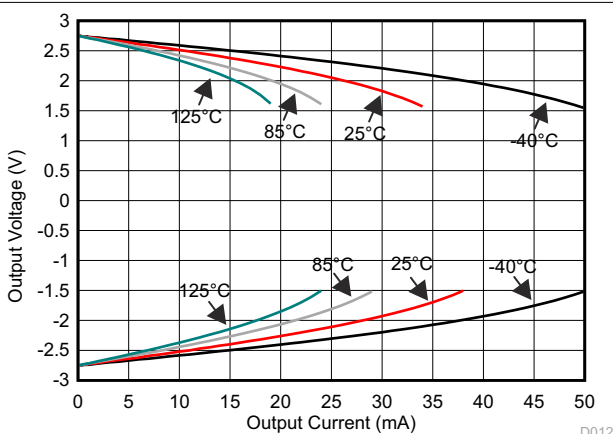


図 6-12. 出力電圧と出力電流との関係 (クロウ)

6.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 2.75\text{V}$, $V_- = -2.75\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (特に記述のない限り)

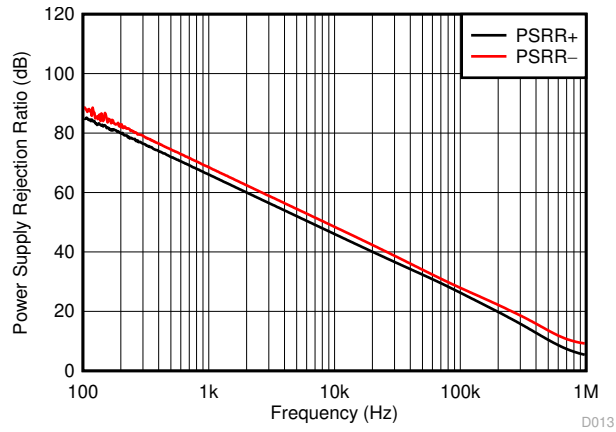


図 6-13. PSRR と周波数との関係

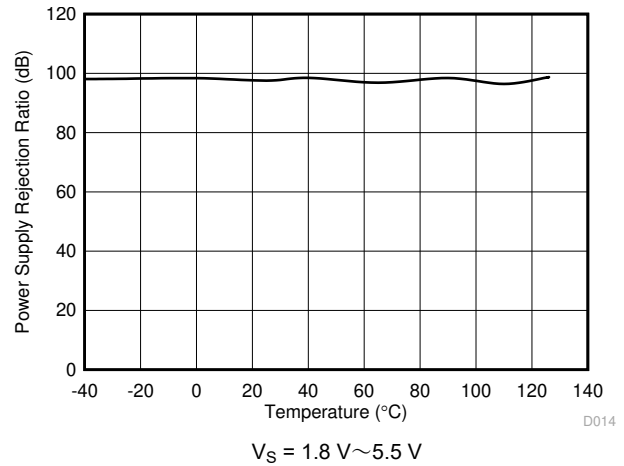


図 6-14. DC PSRR と温度との関係

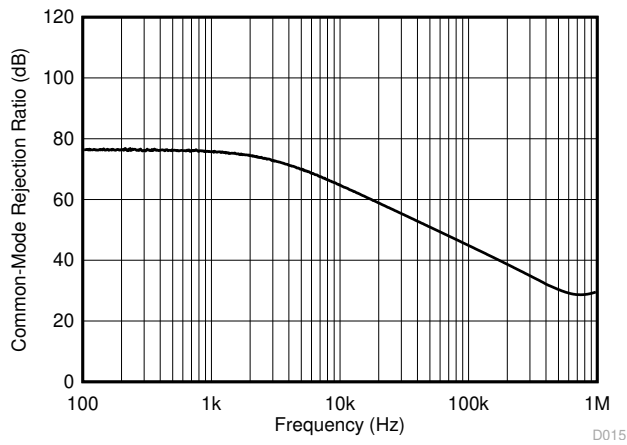


図 6-15. CMRR と周波数との関係

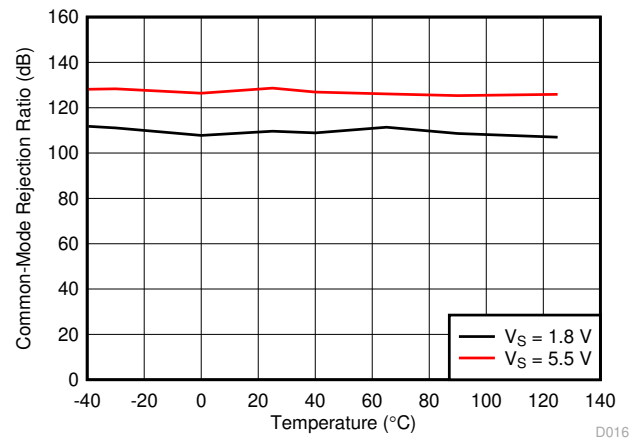


図 6-16. DC CMRR と温度との関係

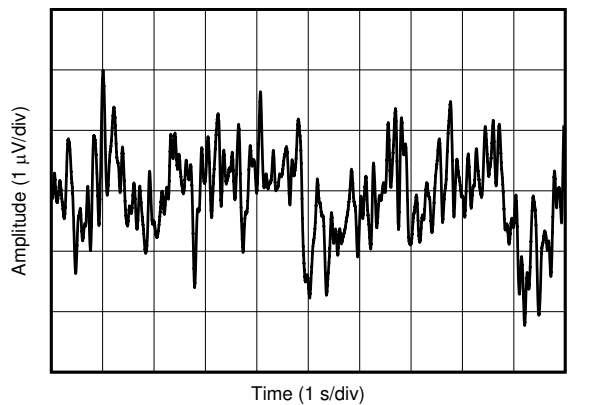


図 6-17. 0.1Hz~10Hz の積分電圧ノイズ

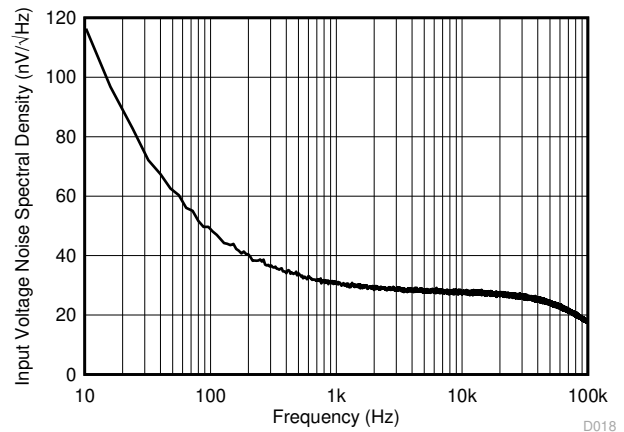


図 6-18. 入力電圧ノイズ スペクトル密度

6.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_+ = 2.75\text{V}$ 、 $V_- = -2.75\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$ 、 $V_{OUT} = V_S/2$ (特に記述のない限り)

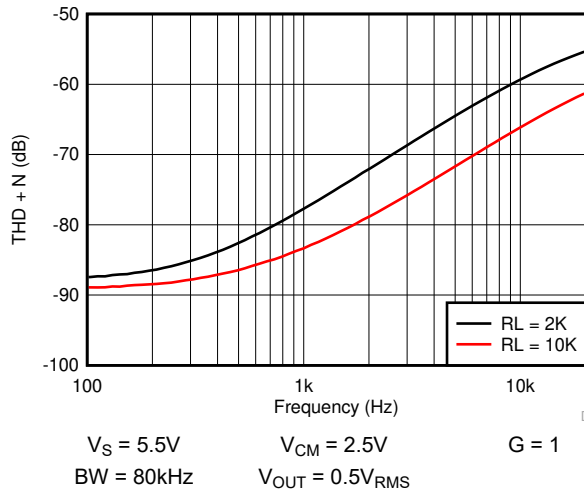


図 6-19. THD + N と周波数との関係

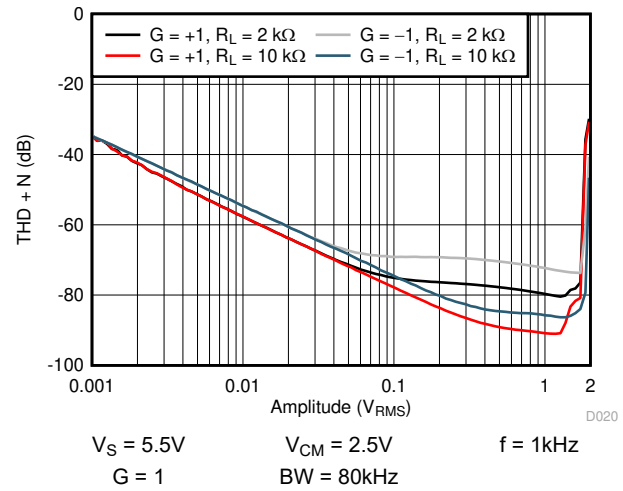


図 6-20. THD + N と振幅との関係

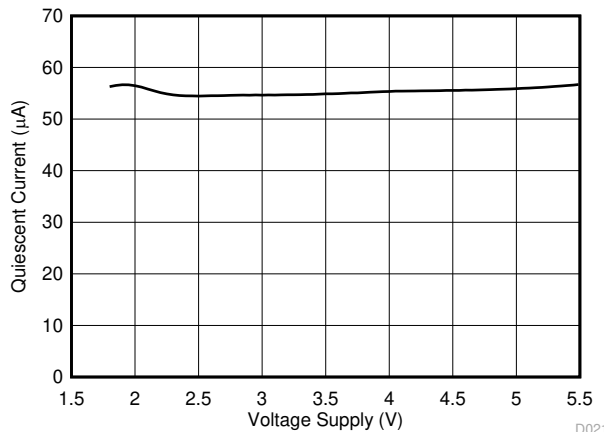


図 6-21. 静止電流と電源電圧との関係

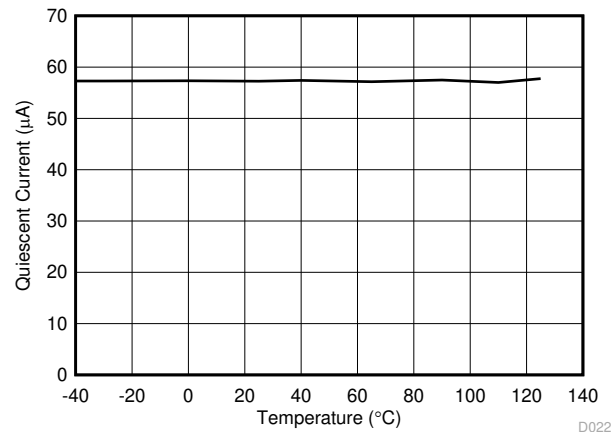


図 6-22. 静止電流と温度との関係

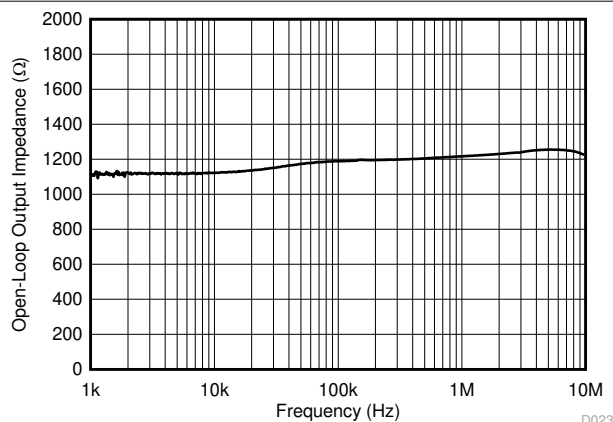


図 6-23. 開ループ出力インピーダンスと周波数との関係

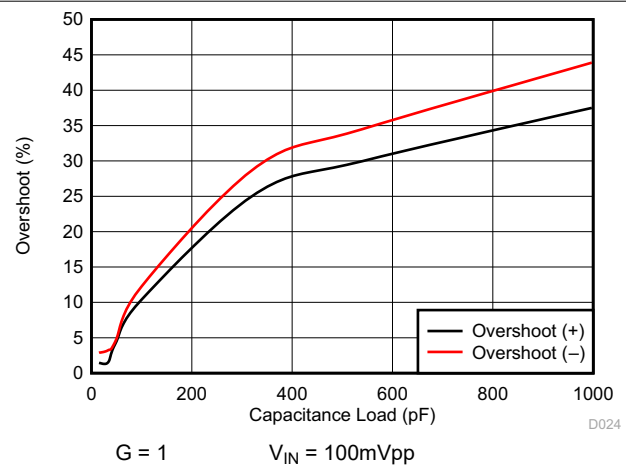


図 6-24. 小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係

6.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 2.75\text{V}$, $V_- = -2.75\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (特に記述のない限り)

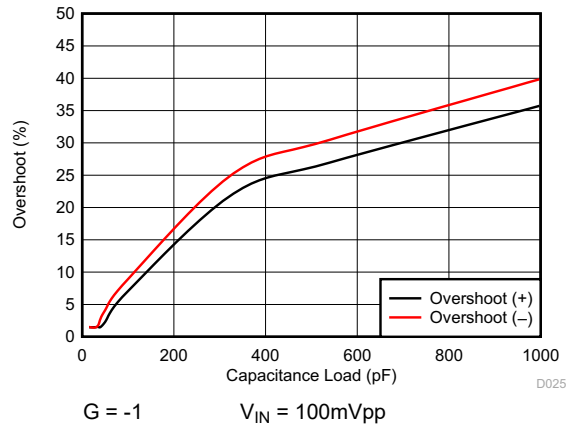


図 6-25. 小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係

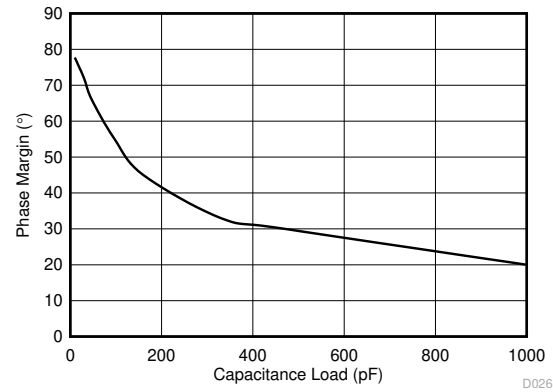


図 6-26. 位相マージンと容量性負荷との関係

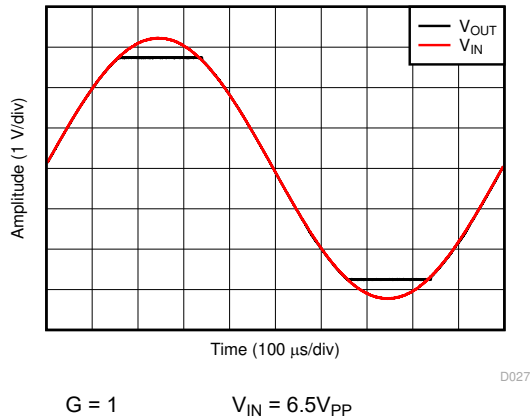


図 6-27. 位相反転が発生しない

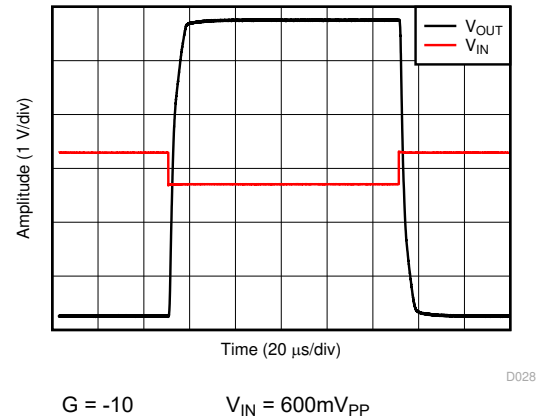


図 6-28. 過負荷回復

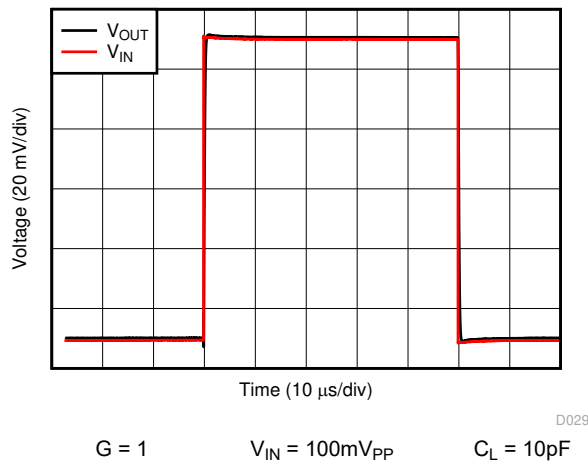


図 6-29. 小信号ステップ応答

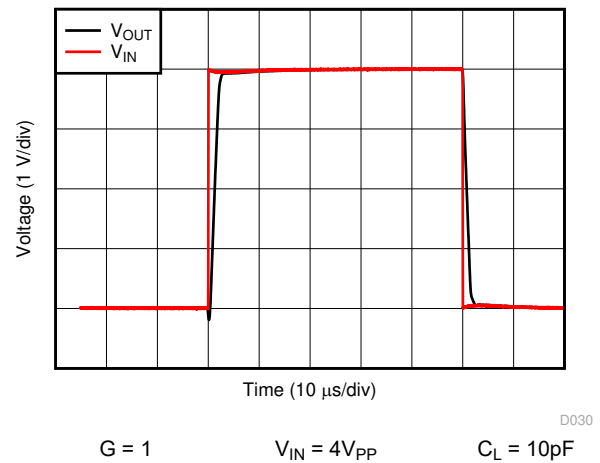


図 6-30. 大信号ステップ応答

6.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 2.75\text{V}$, $V_- = -2.75\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (特に記述のない限り)

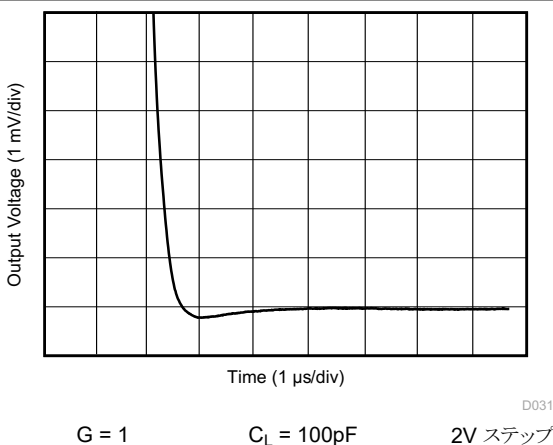


図 6-31. 大信号セトリング タイム (負)

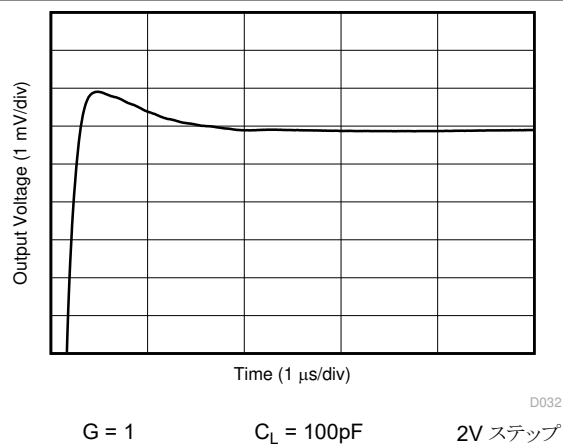


図 6-32. 大信号セトリング タイム (正)

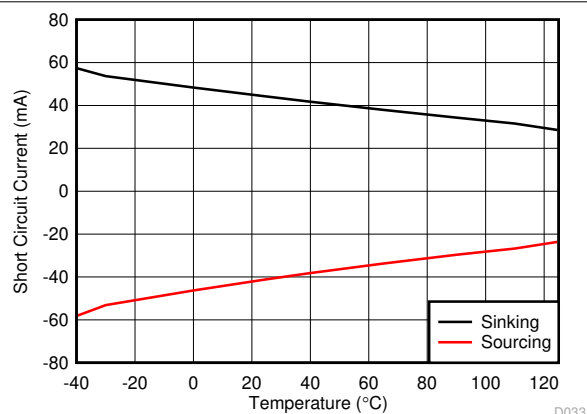


図 6-33. 短絡電流と温度との関係

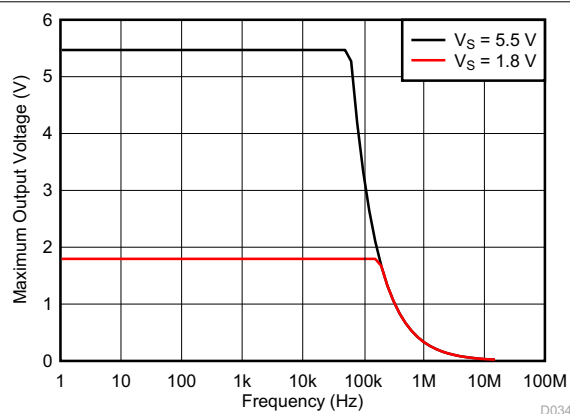


図 6-34. 最大出力電圧と周波数との関係

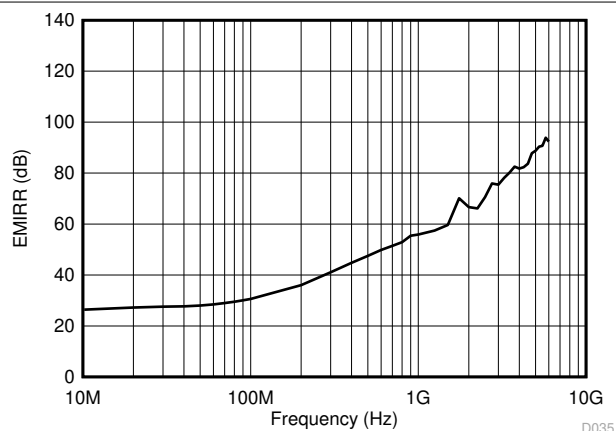


図 6-35. 非反転入力を基準とする電磁干渉除去比 (EMIRR+) と周波数との関係

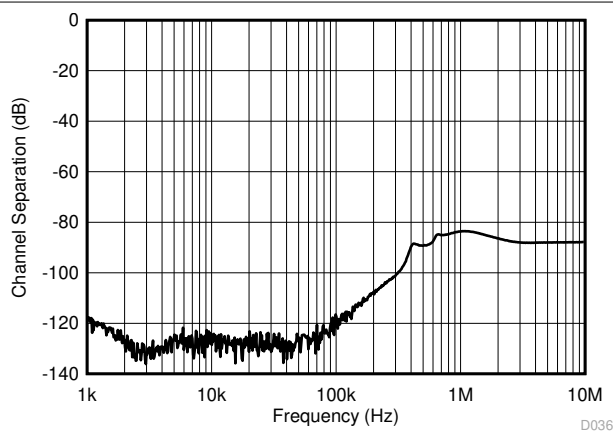


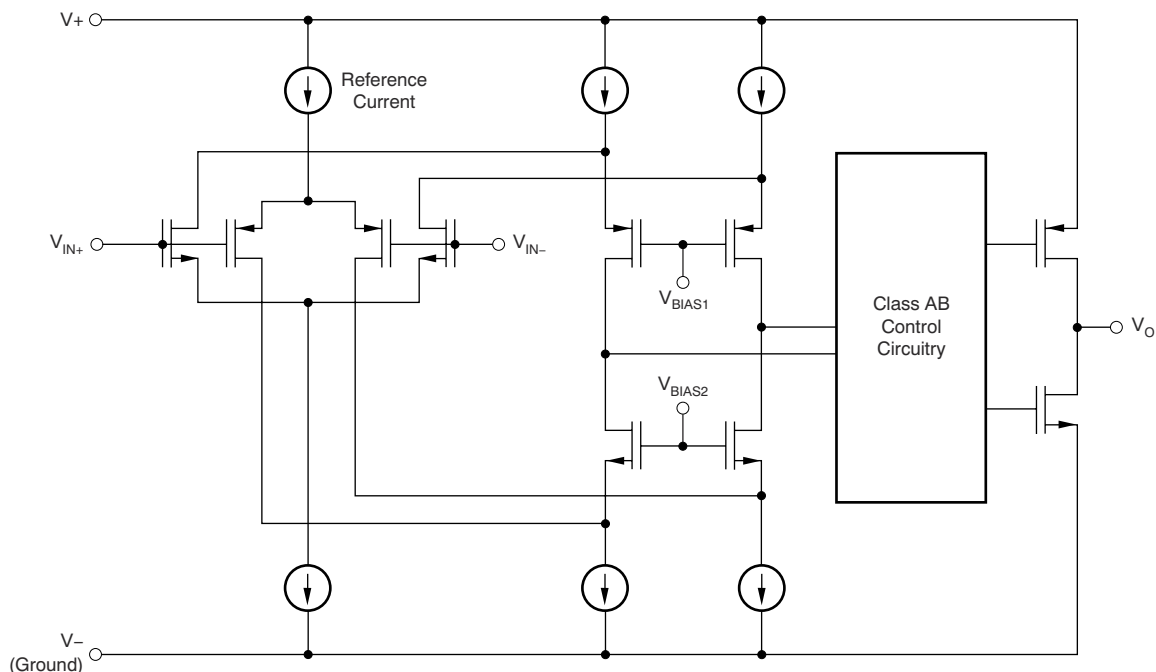
図 6-36. チャネル セパレーション

7 詳細説明

7.1 概要

TLV900x-Q1 は、車載向けに認定された低消費電力のレール ツー レール入力および出力オペアンプのファミリです。これらのデバイスは $1.8V \sim 5.5V$ で動作し、ユニティ ゲインで安定しており、幅広い汎用アプリケーションのために設計されています。入力同相電圧範囲には両方のレールが含まれており、TLV900x-Q1 ファミリを事実上あらゆる単一電源アプリケーションで使用できます。レール ツー レールの入出力スイングにより、特に低電源アプリケーションでダイナミックレンジが大幅に拡大し、サンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動に最適な選択肢となります。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

7.3.1 動作電圧

TLV900x-xx-Q1 ファミリのオペアンプは、1.8V ~ 5.5V で動作します。また、入力オフセット電圧、静止電流、オフセット電流、短絡電流など多くの仕様は、 -40°C ~ 125°C で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを、「代表的特性」セクションに示します。

7.3.2 レール ツー レール入力

TLV900x-Q1 ファミリの入力同相電圧範囲は、1.8V ~ 5.5V の電源電圧範囲全体で、電源レールを 100mV 上回ります。この性能は、「機能ブロック図」セクションに示すように、コンプリメンタリ入力段 (P チャネル差動ペアと並んで配置された N チャネル入力差動ペア) により達成されます。N チャネル ペアは、正のレールに近い入力電圧についてアクティブになります。通常は (V+) - 1.4V から、正の電源電圧よりも 100mV 高い電圧までです。一方、P チャネル ペアは負の電源電圧より 100mV 下から、(V+) - 1.4V 程度までの入力についてアクティブになります。両方のペアが動作する小さな遷移領域があり、通常は (V+) - 1.2V ~ (V+) - 1V の範囲です。この 100mV の遷移領域は、プロセスのバラツキにより、最大 100mV まで変動する可能性があります。したがって、過渡領域 (両方の段がオンになる) は、Low では (V+) - 1.4V ~ (V+) - 1.2V、High 側では最大 (V+) - 1V ~ (V+) - 0.8V の範囲になる可能性があります。この遷移領域内では、この領域の外側でデバイスが動作しているときと比較して、PSRR、CMRR、オフセット電圧、オフセットドリフト、THD が劣化する可能性があります。

7.3.3 レール ツー レール出力

TLV900x-Q1 ファミリは、低消費電力、低電圧のオペアンプとして設計されており、堅牢な出力駆動が可能です。共通ソースのトランジスタを持つ Class-AB 出力段により、レール ツー レールの出力スイング能力が得られます。抵抗性負荷が 10k Ω の場合、印加されている電源電圧に関係なく、どちらの電源レールに対しても出力が 20mV 以内までスイングします。アンプがレールのどれだけ近くまでスイングできるかは、負荷条件によって変化します。

7.3.4 過負荷回復

過負荷からの回復は、オペアンプの出力が飽和状態から線形状態に回復するために必要な時間として定義されます。高い入力電圧または高いゲインが原因で、出力電圧が定格動作電圧を超えると、オペアンプの出力デバイスは飽和領域に入ります。デバイスが飽和領域に入った後、出力デバイスのチャージ キャリアは線形状態に回復するための時間を必要とします。チャージ キャリアが線形状態に戻ると、デバイスは指定されたスルーレートでスルーを開始します。したがって、過負荷状態の場合の伝搬遅延は、過負荷復帰時間とスルー時間の合計になります。TLV900x-Q1 ファミリの過負荷復帰時間は約 850ns です。

7.4 デバイスの機能モード

TLV900x-Q1 ファミリは 1 つの機能モードを持っています。電源電圧が 1.8V ($\pm 0.9\text{V}$) と 5.5V ($\pm 2.75\text{V}$) の間にある限り、本デバイスは機能します。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

TLV900x-Q1 ファミリの低消費電力、レール ツー レール入力および出力オペアンプは、ポータブル アプリケーションに特化して設計されています。本デバイスは 1.8V ~ 5.5V で動作し、ユニティゲインで安定しているため、幅広い汎用アプリケーションに適しています。Class-AB の出力段は、V+ と V- との間の任意のポイントに接続される 10k Ω 以下の負荷を駆動できます。入力同相電圧範囲には両方のレールが含まれており、TLV900x-Q1 デバイスをあらゆる単一電源アプリケーションで使用できます。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 TLV900x-Q1 ローサイド電流センシング アプリケーション

図 8-1 に、ローサイド電流センシング アプリケーション用に構成された TLV900x-Q1 を示します。

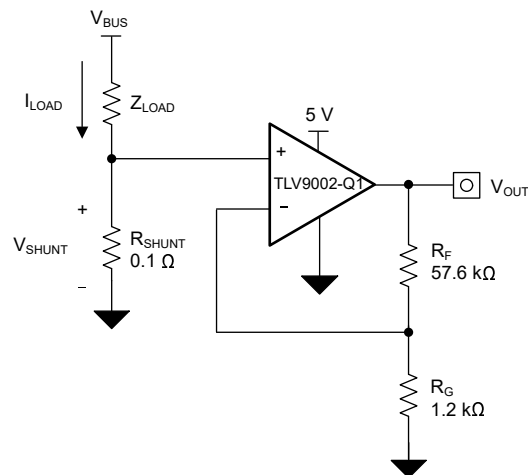


図 8-1. ローサイド電流センシング アプリケーションの TLV900x-Q1

8.2.1.1 設計要件

この設計の設計要件は次のとおりです。

- 負荷電流: 0A～1A
- 出力電圧: 4.9V
- 最大シャント電圧: 100mV

8.2.1.2 詳細な設計手順

図 8-1 の回路の伝達関数は、式 1 に示すとおりです。

$$V_{OUT} = I_{LOAD} \times R_{SHUNT} \times Gain \quad (1)$$

負荷電流 (I_{LOAD}) により、シャント抵抗 (R_{SHUNT}) の両端で電圧降下が発生します。負荷電流は 0A～1A の範囲で設定されます。最大負荷電流時のシャント電圧を 100mV 未満に維持するために、最大シャント抵抗は 式 2 を使用して示されます。

$$R_{SHUNT} = \frac{V_{SHUNT_MAX}}{I_{LOAD_MAX}} = \frac{100\text{ mV}}{1\text{ A}} = 100\text{ m}\Omega \quad (2)$$

式 2 を使用して計算すると、 R_{SHUNT} は 100m Ω となります。 I_{LOAD} と R_{SHUNT} によって生成される電圧降下は TLV900x-Q1 によって増幅され、約 0V ～ 4.9V の出力電圧を生成します。TLV900x-Q1 が必要な出力電圧を生成するために必要なゲインは、式 3 を使用して計算されます。

$$Gain = \frac{(V_{OUT_MAX} - V_{OUT_MIN})}{(V_{IN_MAX} - V_{IN_MIN})} \quad (3)$$

式 3 を使用して計算すると、必要なゲインは 49V/V となります。これは抵抗 R_F と R_G で設定します。TLV900x-Q1 デバイスのゲインを 49V/V に設定するための抵抗 R_F および R_G のサイズは式 4 で計算します。

$$Gain = 1 + \frac{(R_F)}{(R_G)} \quad (4)$$

R_F に 57.6k Ω 、 R_G に 1.2k Ω を選択すると、組み合わせで 49V/V に等しくなります。図 8-1 に示す回路で測定された伝達関数を、図 8-2 に示します。ゲインは、帰還抵抗とゲイン抵抗のみの関数であることに注意します。このゲインは抵抗の比を変化させることで調整され、実際の抵抗値は設計者が設定しようとするインピーダンスレベルによって決定されます。インピーダンスレベルによって、電流ドレイン、浮遊容量の影響、その他いくつかの動作が決まります。特定のインピーダンスの選択はシステムごとに異なるので、システムのパラメータに基づいてインピーダンスを選択する必要があります。

8.2.1.3 アプリケーション曲線

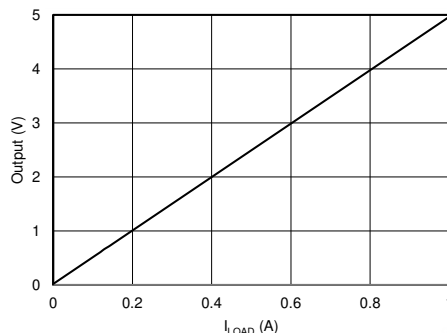


図 8-2. ローサイド、電流センス、伝達関数

8.2.2 単一電源のフォトダイオード アンプ

フォトダイオードは、光信号を電気信号に変換するために多くのアプリケーションで使用されています。フォトダイオードを流れる電流は吸収される光子エネルギーに比例し、一般に数百 pA から数十 μ A の範囲内です。低レベルのフォトダイオード電流を、MCU で処理するための電圧信号に変換するために、トランスインピーダンス構成のアンプが通常使用されます。図 8-3 に示す回路は、TLV9002-Q1 を使った単一電源フォトダイオード アンプ回路の例です。

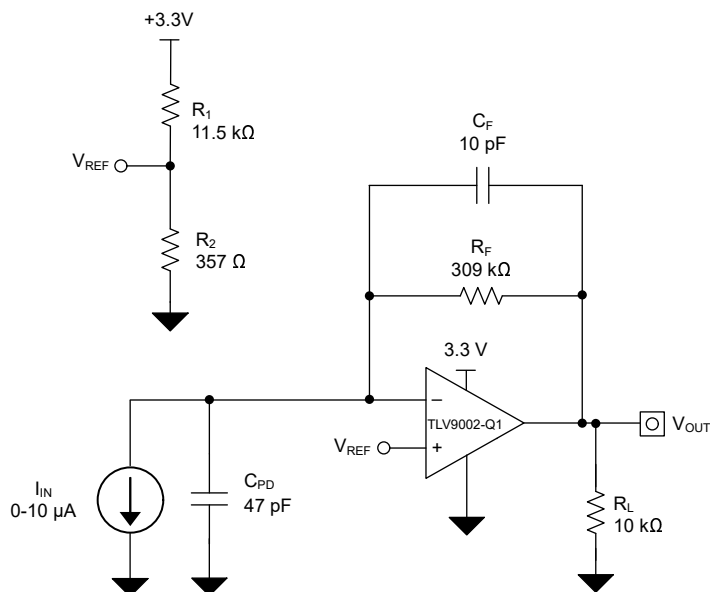


図 8-3. 単一電源のフォトダイオード アンプ回路

8.2.2.1 設計要件

この設計の設計要件は次のとおりです。

- 電源電圧: 3.3V
- 入力: 0μA ~ 10μA
- 出力: 0.1V ~ 3.2V
- 帯域幅: 50kHz

8.2.2.2 詳細な設計手順

出力電圧 (V_{OUT})、入力電流 (I_{IN})、基準電圧 (V_{REF}) の間の伝達関数は、式 5 で定義されます。

$$V_{OUT} = I_{IN} \times R_F + V_{REF} \quad (5)$$

ここで

$$V_{REF} = V_+ \times \left(\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \right) \quad (6)$$

式 7 で計算された必要比率を満たすように R_1 と R_2 を設定することで、最小出力電圧レベルを満たす 100mV に V_{REF} を設定します。

$$\frac{V_{REF}}{V_+} = \frac{0.1V}{3.3V} = 0.0303 \quad (7)$$

この比率を満たす最も近い抵抗比から、 R_1 は 11.5kΩ、 R_2 は 357Ω に設定されます。

必要な帰還抵抗は、入力電流と目的の出力電圧に基づいて計算できます。

$$R_F = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{I_{IN}} = \frac{3.2V - 0.1V}{10\mu A} = 310 \frac{kV}{A} \approx 309 k\Omega \quad (8)$$

式 9 を使い、 R_F と目的の -3dB 帯域幅 (f_{-3dB}) に基づいて、帰還コンデンサの値を計算します。

$$C_F = \frac{1}{2 \times \pi \times R_F \times f_{-3dB}} = \frac{1}{2 \times \pi \times 309 k\Omega \times 50 kHz} = 10.3 pF \approx 10 pF \quad (9)$$

このアプリケーションに必要なオペアンプ帯域幅の最小値は R_F 、 C_F 、TLV9002-Q1 の INx - ピンの容量によって決まります。この INx - ピンの容量は、フォトダイオードのシャント容量 (CPD)、同相入力容量 (CCM)、差動入力容量 (CD) の合計と同じです (式 10 を参照)。

$$C_{IN} = C_{PD} + C_{CM} + C_D = 47 pF + 5 pF + 1 pF = 53 pF \quad (10)$$

最小オペアンプ帯域幅は、式 11 で計算されます。

$$f = BGW \geq \frac{C_{IN} + C_F}{2 \times \pi \times R_F \times C_F} \geq 324 kHz \quad (11)$$

TLV900x-Q1 の 1MHz 帯域幅は最小帯域幅要件を満たしており、このアプリケーション構成でも安定状態を維持します。

8.2.2.3 アプリケーション曲線

フォトダイオード アンプ回路について測定される電流から電圧への変換機能を、[図 8-4](#) に示します。フォトダイオード アンプ回路について測定される性能を、[図 8-5](#) に示します。

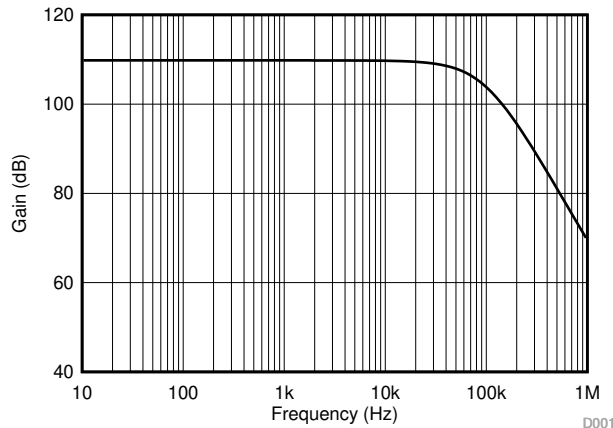


図 8-4. フォトダイオード アンプ回路の AC ゲイン結果

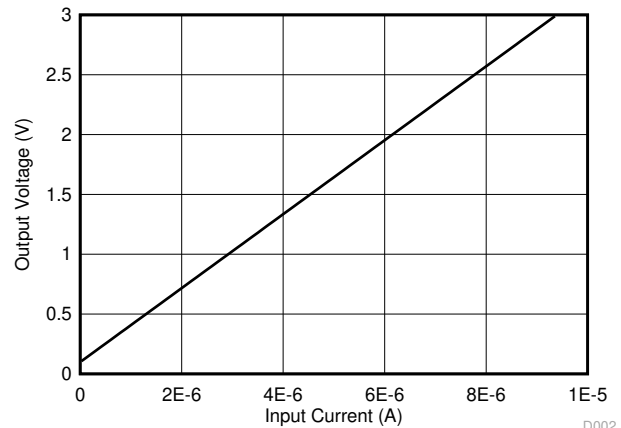


図 8-5. フォトダイオード アンプ回路の DC 結果

8.3 電源に関する推奨事項

TLV900x-Q1 ファミリーは、1.8V ~ 5.5V ($\pm 0.9V \sim \pm 2.75V$) での動作が規定されています。多くの仕様は、 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ で適用されます。「[代表的特性](#)」セクションには、動作電圧または温度に関して大きな変動をもたらす可能性のあるパラメータが記載されています。

注意

6V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「[絶対最大定格](#)」表を参照してください。

電源ピンの近くに 0.1 μF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合による誤差を低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、「[レイアウトのガイドライン](#)」セクションを参照してください。

8.3.1 入力および ESD 保護

TLV900x-Q1 ファミリーには、すべてのピンに内部 ESD 保護回路が組み込まれています。入力ピンと出力ピンの場合、この保護は主に入力ピンと電源ピンとの間に接続された電流ステアリング ダイオードで構成されます。これらの ESD 保護ダイオードは、電流が 10mA に制限されている限り、回路内で入力オーバードライブの保護を行います。駆動入力に直列入力抵抗を追加して入力電流を制限する方法を、[図 8-6](#) に示します。追加された抵抗はアンプの入力で熱ノイズを引き起こすため、ノイズに敏感なアプリケーションでは値を最小限に抑える必要があります。

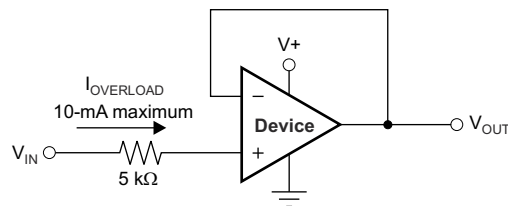


図 8-6. 入力電流保護

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

デバイスで最高の動作性能を実現するため、以下のような優れた PCB レイアウト手法を使用してください。

- ノイズは、基板の電源接続を通じてアナログ回路に伝播し、オペアンプの電源ピンにまで達する可能性があります。バイパスコンデンサは、結合ノイズを低減するために使用され、低インピーダンスの経路を介してグラウンドへ逃がす役割を果たします。
 - 各電源ピンとグラウンドとの間に、低 ESR の $0.1\mu\text{F}$ セラミック バイパス コンデンサを接続し、可能な限りデバイスの近くに配置します。単一電源アプリケーションの場合は、 $V+$ からグラウンドに対して単一のバイパス コンデンサを接続すれば十分です。
- 回路のアナログ部分とデジタル部分のグラウンドを分離することは、ノイズを抑制する最も簡単かつ効果的な方法の 1 つです。通常、多層 PCB のうち 1 つ以上の層はグラウンド プレーン専用です。グラウンド プレーンは熱の分散に役立ち、EMI (電磁干渉) ノイズを拾いにくくなります。デジタル グラウンドとアナログ グラウンドを物理的に分離し、グラウンド電流の流れに注意を払います。詳細については、「[回路基板のレイアウト技法](#)」を参照してください。
- 寄生カップリングを低減するため、入力トレースを電源トレースと出力トレースからできるだけ離して配置します。これらの配線を分離しておけない場合、敏感な配線をノイズの多い配線と平行にするよりは、垂直に交差させる方がはるかに良い結果が得られます。
- 外付け部品は、可能な限りデバイスに近く配置します (図 8-8 を参照)。 R_F と R_G を反転入力に近付けて配置すると、寄生容量を最小化できます。
- 入力トレースは、できる限り短くします。入力配線は回路の最も敏感な部分であることに注意します。
- 重要なトレースの周囲に、駆動される低インピーダンスのガードリングを配置することを検討してください。ガードリングを使用すると、付近に存在する、さまざまな電位のトレースからのリーク電流を大幅に低減できます。
- 最高の性能を実現するため、基板組み立ての後で PCB を清掃することを推奨します。
- 高精度の集積回路では、プラスチック パッケージへの水分の侵入により性能が変化する場合があります。PCB を水で洗浄してから、PCB アセンブリをベーキングして、清掃プロセス中にデバイスのパッケージに侵入した水分を除去することを推奨します。ほとんどの状況では、クリーニング後に 85°C で 30 分間の低温ベーキングを行えば十分です。

8.4.2 レイアウト例

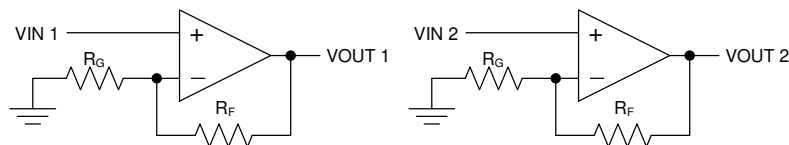


図 8-7. 図 11-2 の回路図

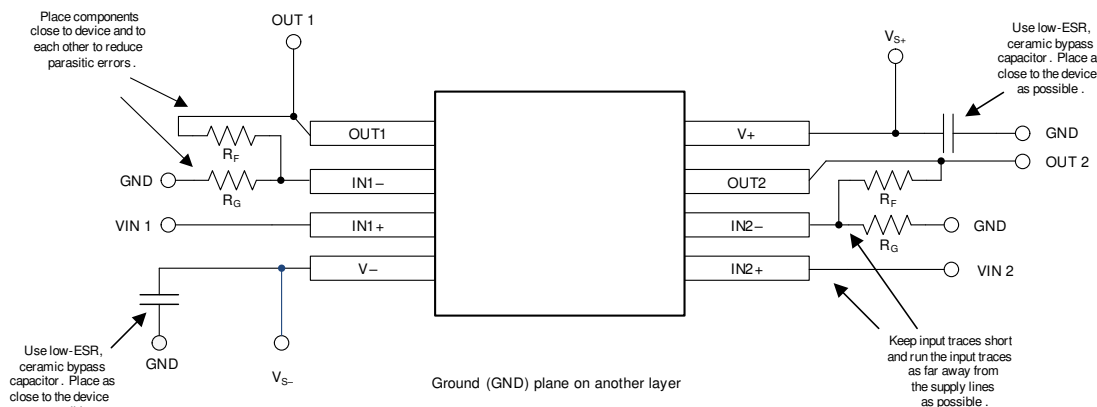


図 8-8. レイアウト例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[オペアンプの EMI 除去率](#)』

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (April 2025) to Revision G (April 2026) Page

- 「ピン構成および機能」セクションに TLV9001U-Q1 DBV (SOT-23) を追加4

Changes from Revision E (April 2023) to Revision F (April 2025) Page

- PW (TSSOP, 8) パッケージのステータスを プレビュー から アクティブに変更..... 1
- データシートに TLV9002RQDGKRQ1 を追加 (Iq 最大値は 85μA).....9

Changes from Revision D (November 2022) to Revision E (April 2023) Page

- DBV パッケージのステータスをプレビューからアクティブに変更 1

Changes from Revision C (October 2021) to Revision D (December 2022) Page

- 「製品情報」セクションから SC70 (5) のプレビュー注記を削除..... 1
- 「ピン構成および機能」セクションのフォーマットを変更..... 4
- シングル チャネル DCK パッケージの熱に関する情報を追加..... 7

Changes from Revision B (March 2021) to Revision C (October 2021) Page

- 「製品情報」セクションから SOT-23 (14) および TSSOP (14) のプレビュー注記を削除 1
- 「製品情報」セクションに TLV9001-Q1 SOT-23 (5) および SC70 (5) パッケージのプレビュー注記を追加 1
- データシートに TLV9001-Q1 GPN を追加.....1
- 「デバイス比較表」セクションに TLV9001-Q1 を追加.....3
- 「ピン構成および機能」セクションに TLV9001-Q1 DBV (SOT-23) および DCK (SC70) を追加..... 4

Changes from Revision A (June 2020) to Revision B (March 2021) Page

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を変更..... 1
- 「特長」セクションに機能安全対応のドキュメントのリンクを追加..... 1
- 「製品情報」セクションから VSSOP (8) のプレビュー タグを削除..... 1
- 「絶対最大定格」表の差動入力電圧に注 4 を追加 7
- DGK パッケージの熱情報を追加..... 8
- DYY パッケージの熱情報を追加..... 8

Changes from Revision * (May 2019) to Revision A (June 2020) Page

- デバイス ステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更..... 1
- 「アプリケーション」セクションに最終機器のリンクを追加..... 1
- 「製品情報」セクションから SOIC (8) のプレビュー タグを削除..... 1
- 「製品情報」セクションに SOT-23 (14) を追加..... 1
- 「製品情報」セクションから SOIC (14) のプレビュー タグを削除..... 1
- 「デバイス比較表」セクションに SOT-23 (DYY) パッケージを追加.....3

- 「ピンの機能: TLV9004-Q1」セクションを追加 4

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLV9001QDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2T5H
TLV9001QDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2T5H
TLV9001QDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1MZ
TLV9001QDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1MZ
TLV9001UQDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	41QF
TLV9002QDGKRQ1	Active	Production	VSSOP (DGK) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	27DT
TLV9002QDGKRQ1.A	Active	Production	VSSOP (DGK) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	27DT
TLV9002QDRQ1	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9002Q
TLV9002QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9002Q
TLV9002QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) 8	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	9002Q
TLV9002QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) 8	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	9002Q
TLV9002RQDGKRQ1	Active	Production	VSSOP (DGK) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	3N8S
TLV9002RQDGKRQ1.A	Active	Production	VSSOP (DGK) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	3N8S
TLV9004QDRQ1	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LV9004Q
TLV9004QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LV9004Q
TLV9004QDYRQ1	Active	Production	SOT-23-THIN (DYY) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TLV9004Q
TLV9004QDYRQ1.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DYY) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TLV9004Q
TLV9004QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9004Q
TLV9004QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9004Q

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

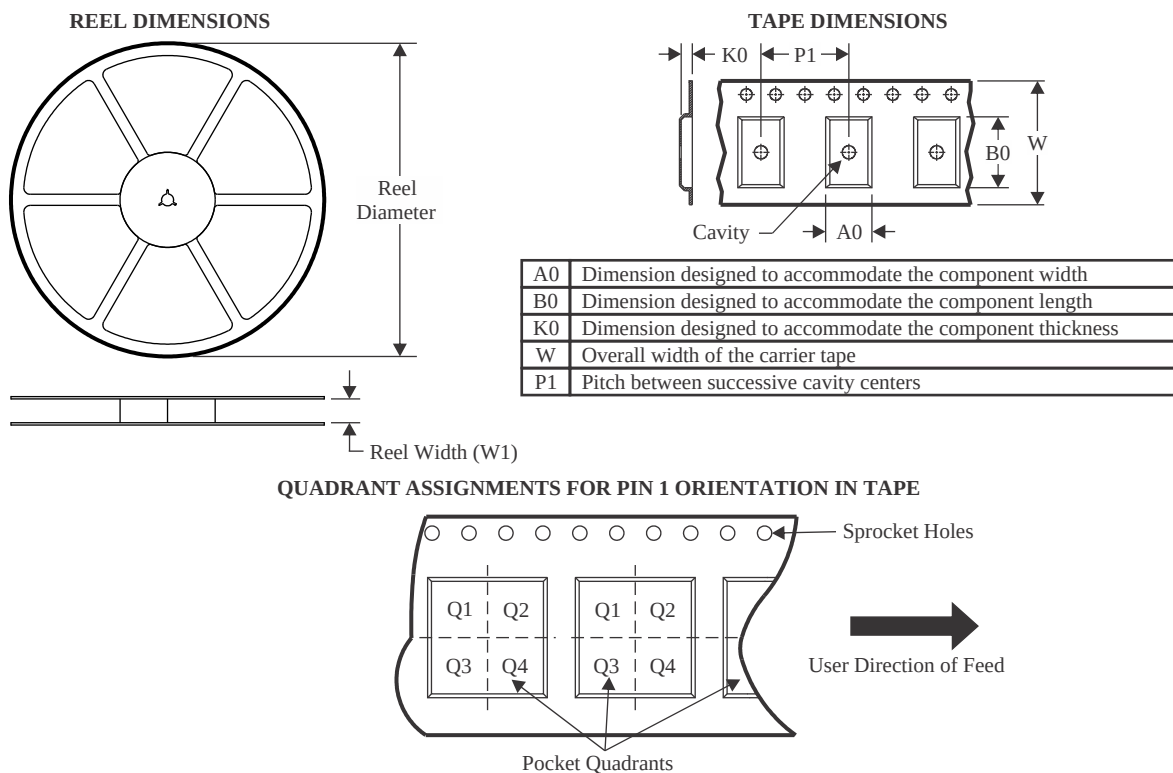
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLV9001-Q1, TLV9002-Q1, TLV9004-Q1 :

- Catalog : [TLV9001](#), [TLV9002](#), [TLV9004](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

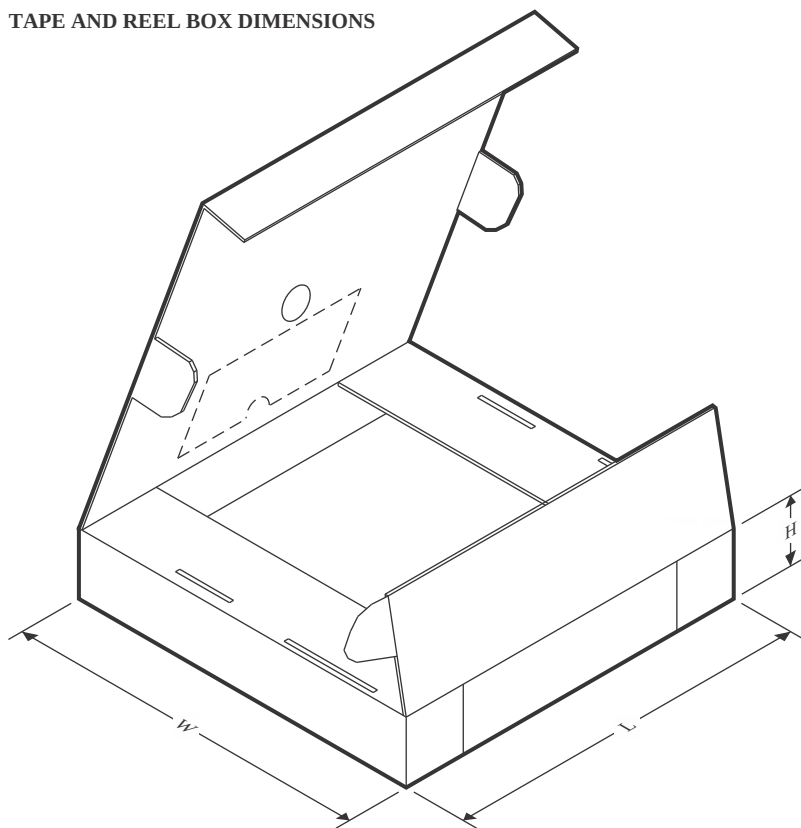
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TLV9001QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV9001QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
TLV9001UQDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV9002QDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
TLV9002QDRQ1	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TLV9002QPWRQ1	TSSOP	PW	8	3000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
TLV9002RQDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
TLV9002RQDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
TLV9004QDRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TLV9004QDYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3
TLV9004QPWRQ1	TSSOP	PW	14	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TLV9001QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TLV9001QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	190.0	190.0	30.0
TLV9001UQDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TLV9002QDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
TLV9002QDRQ1	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TLV9002QPWRQ1	TSSOP	PW	8	3000	353.0	353.0	32.0
TLV9002RQDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
TLV9002RQDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
TLV9004QDRQ1	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TLV9004QDYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	336.6	336.6	31.8
TLV9004QPWRQ1	TSSOP	PW	14	3000	353.0	353.0	32.0

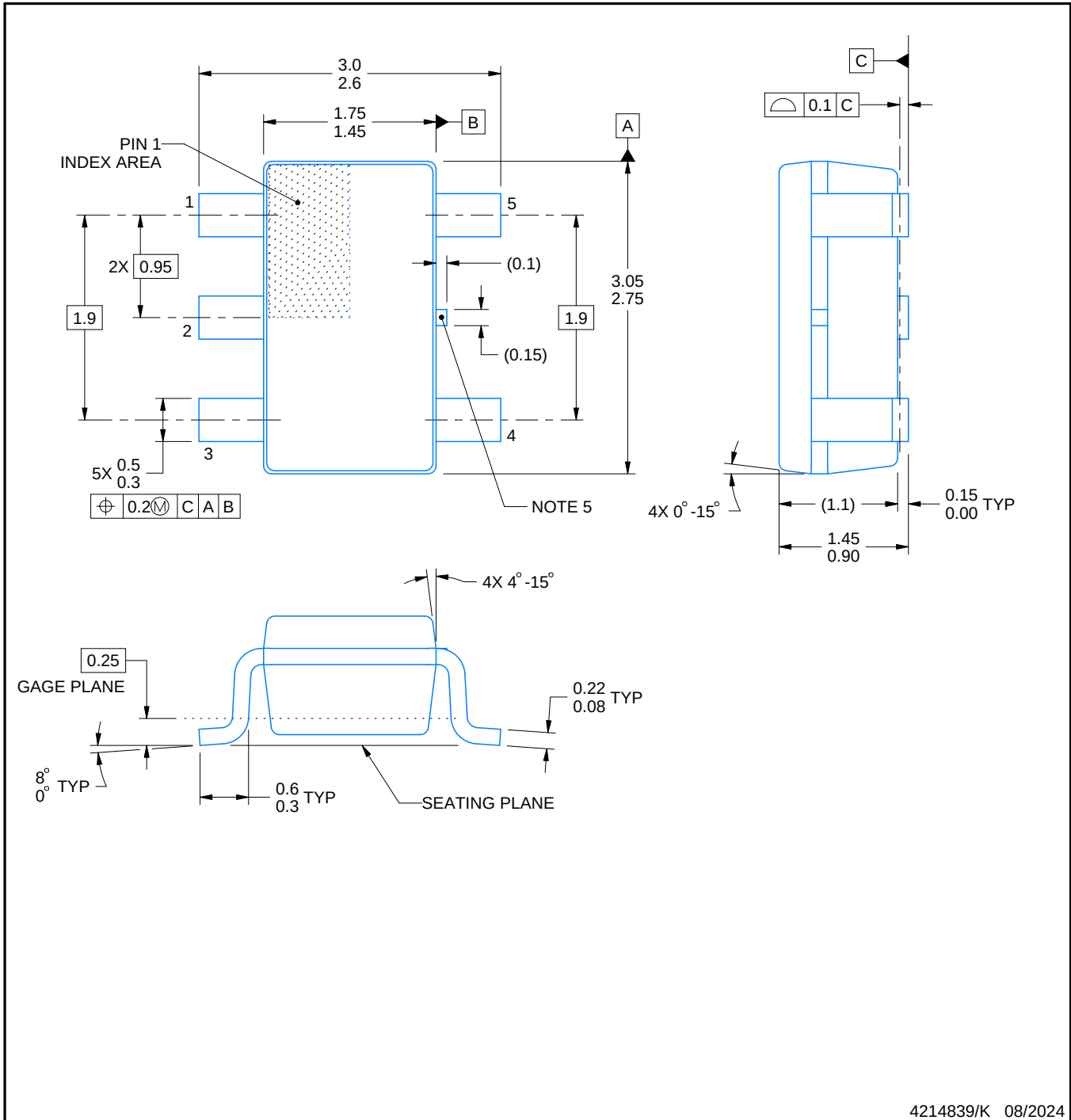


DBV0005A

PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



NOTES:

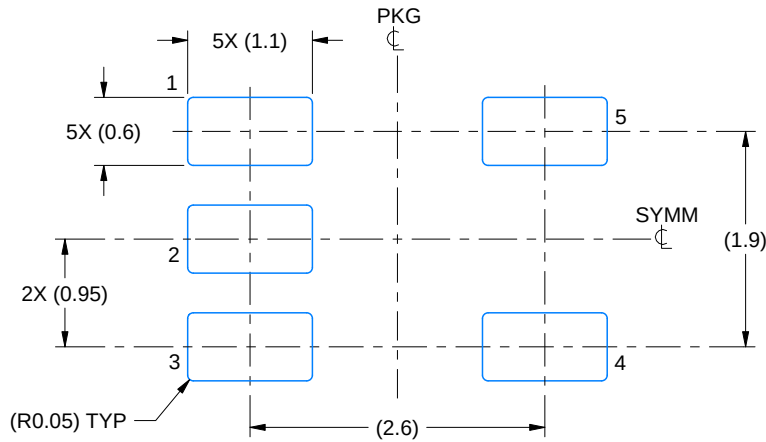
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

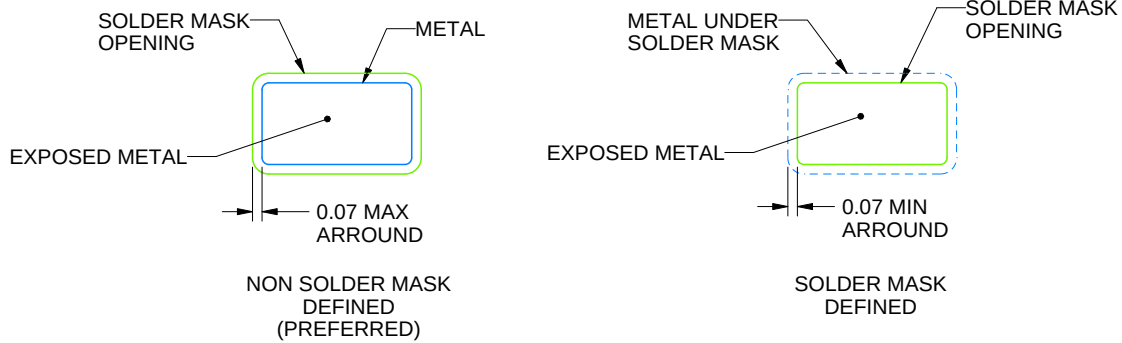
DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

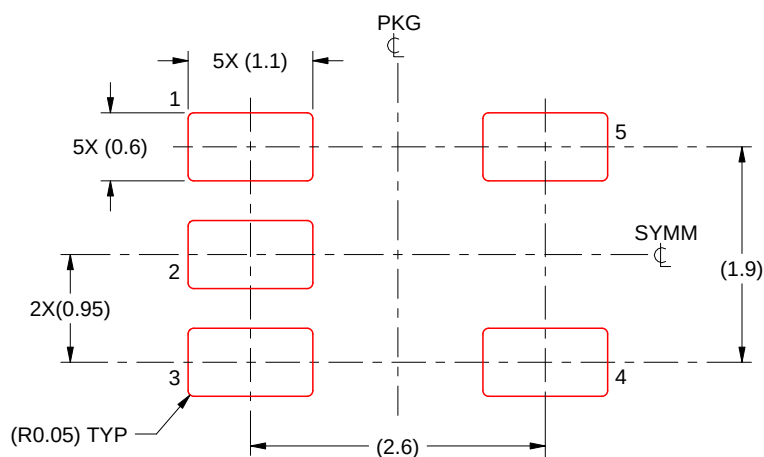
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



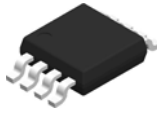
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

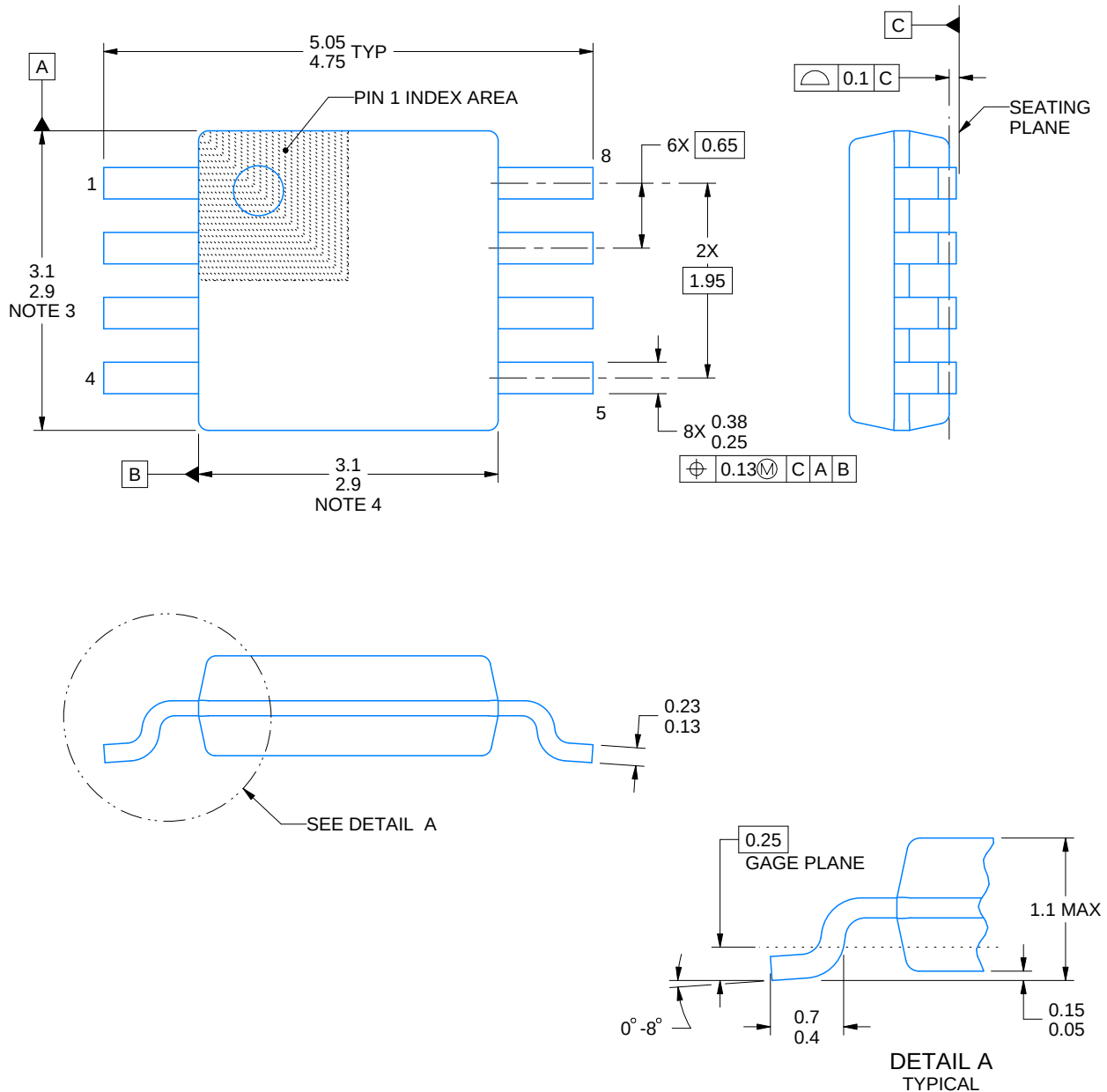
DGK0008A



PACKAGE OUTLINE

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4214862/A 04/2023

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

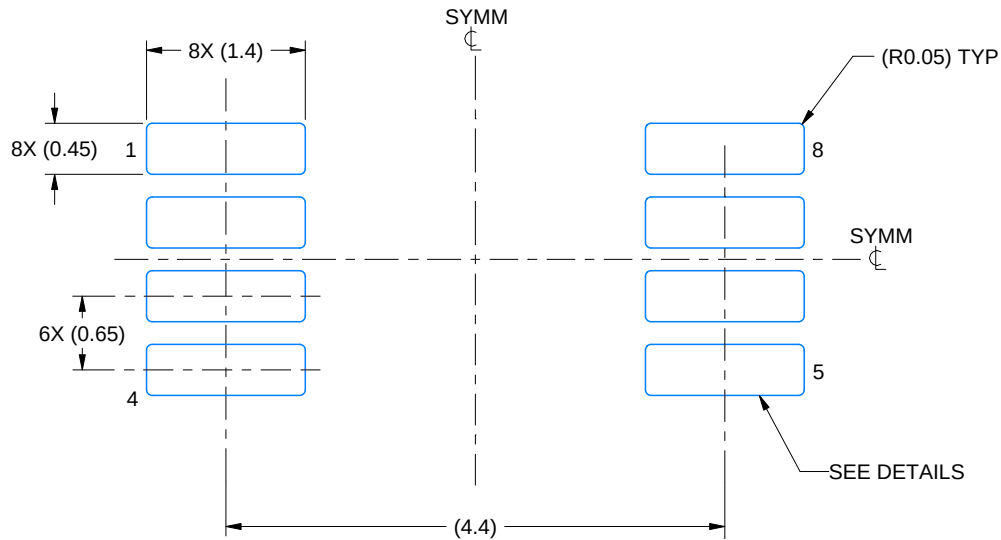
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

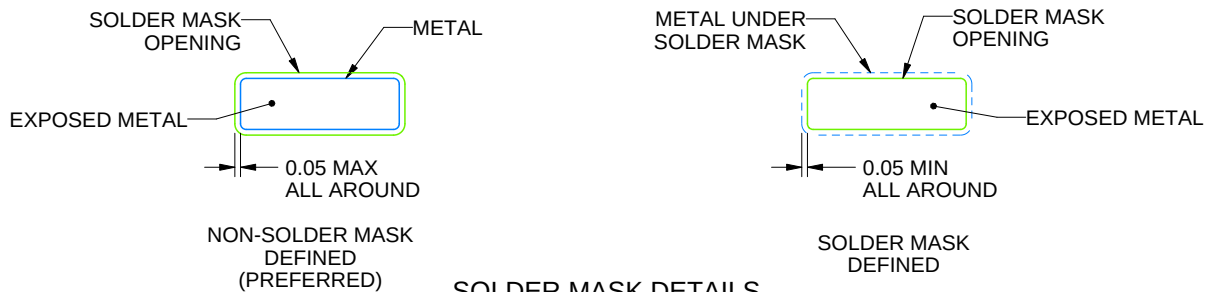
DGK0008A

TM VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X



SOLDER MASK DETAILS

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

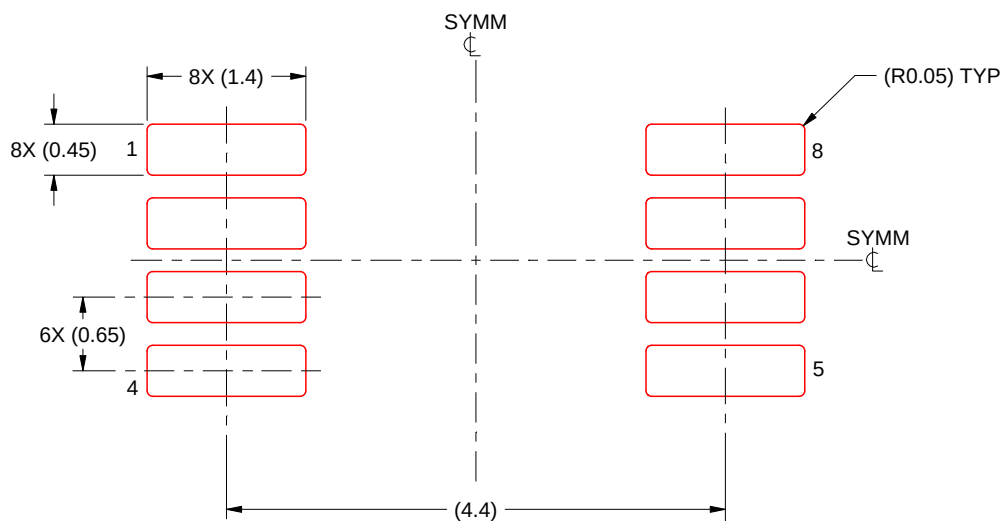
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGK0008A

TM VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

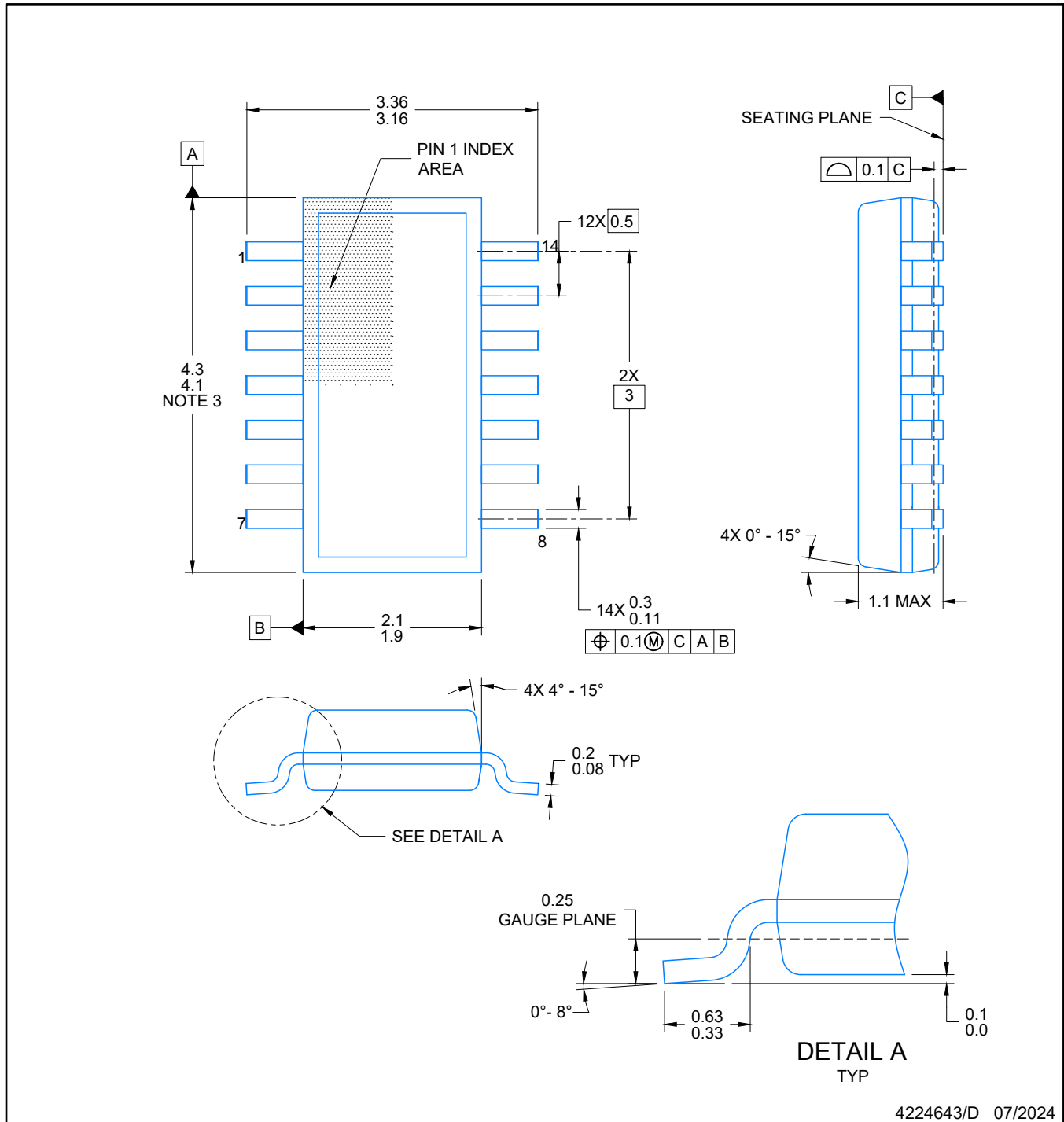


SOLDER PASTE EXAMPLE
SCALE: 15X

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

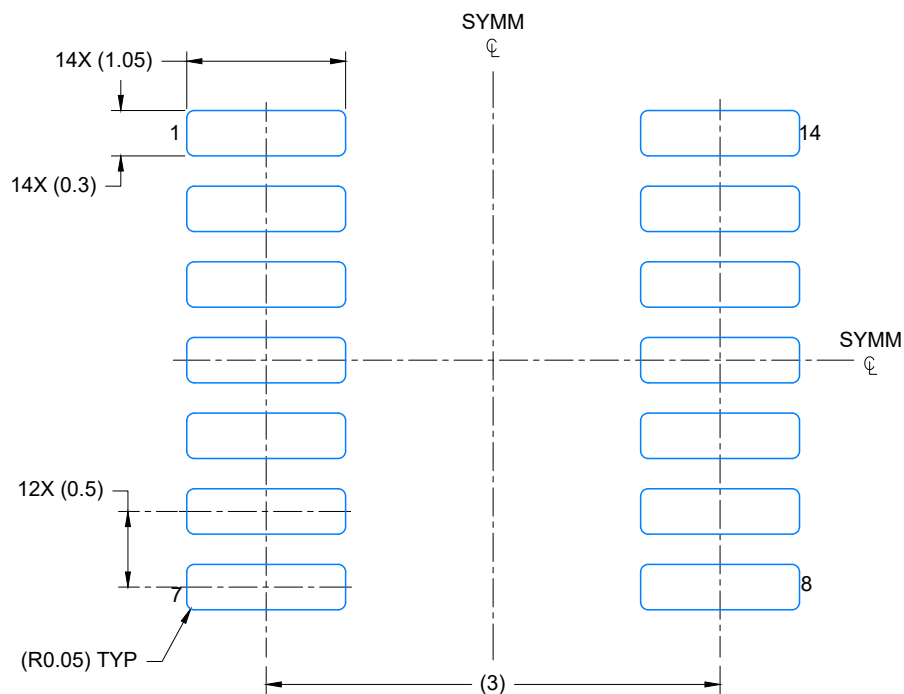
11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



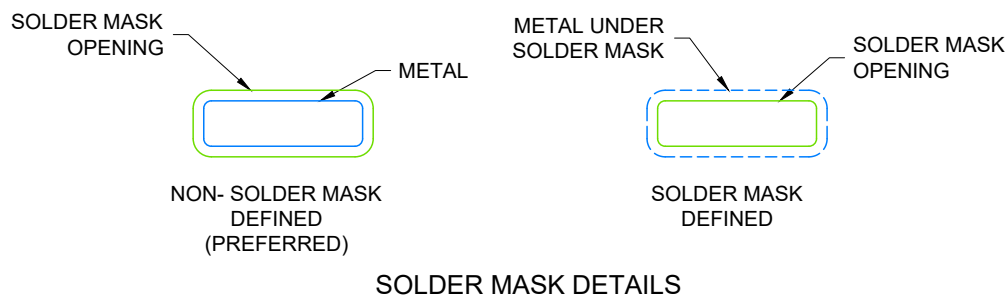
4224643/D 07/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AB



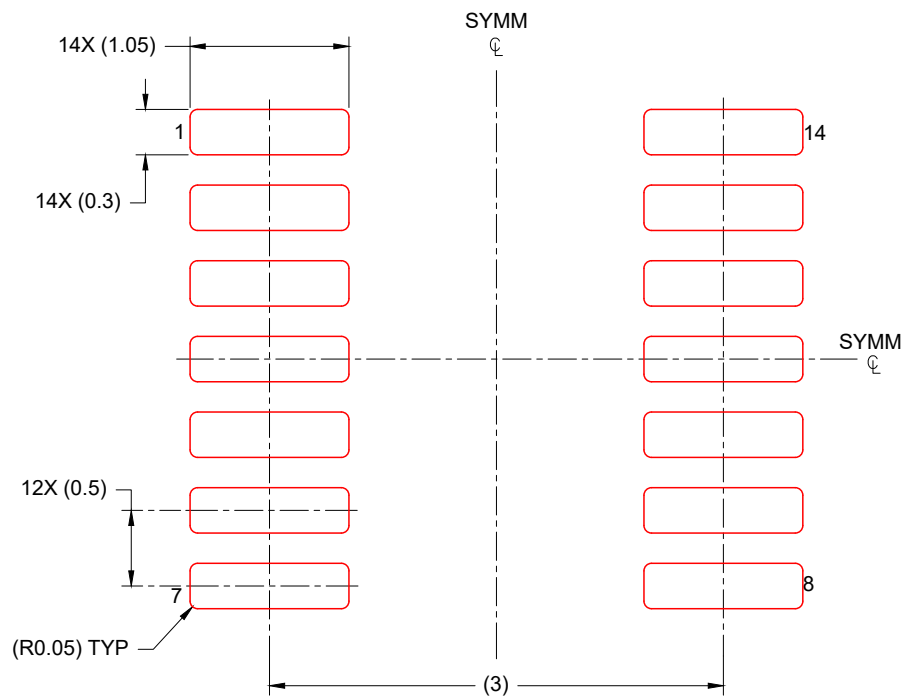
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

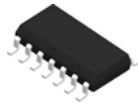


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 20X

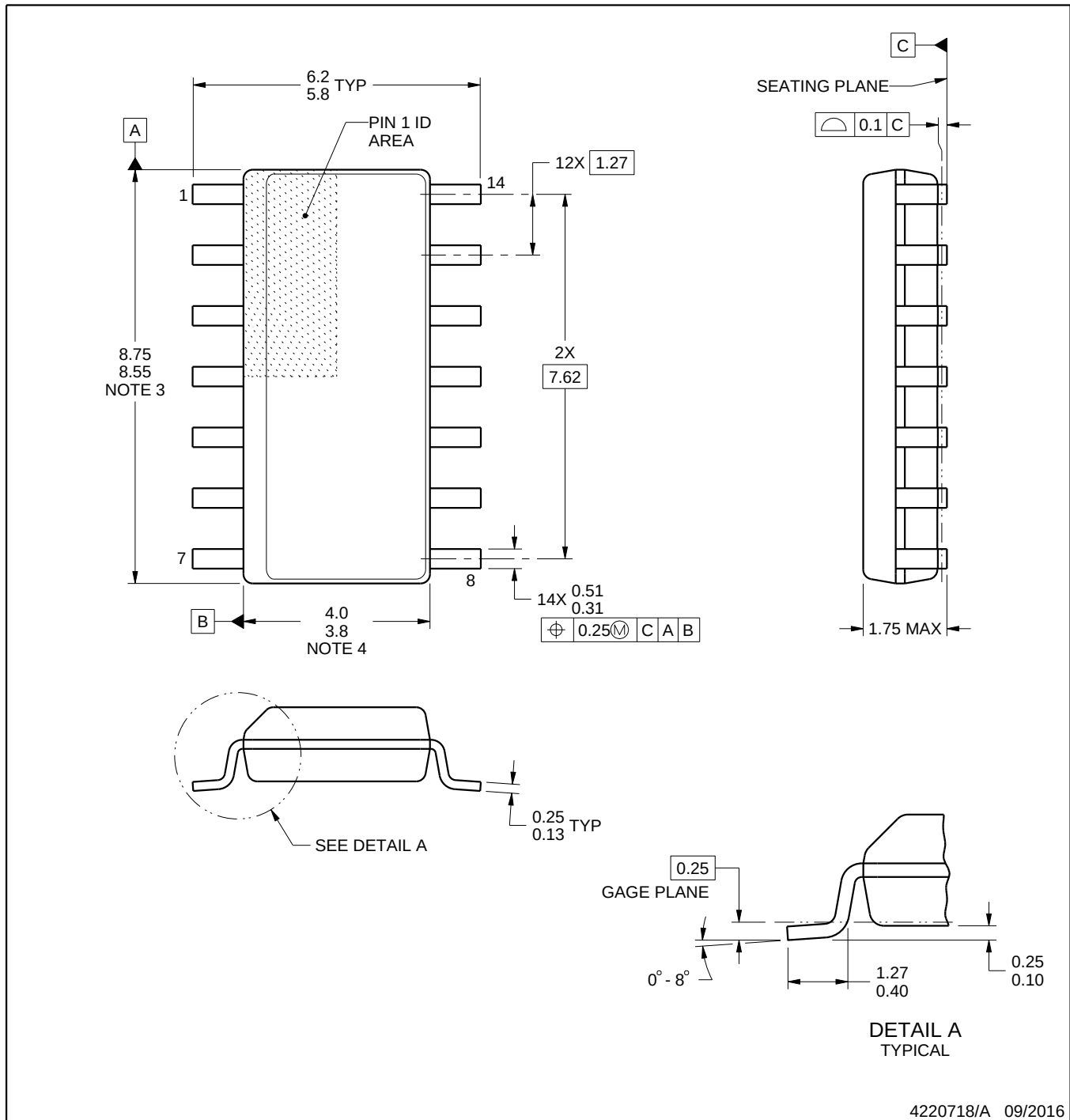
4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

D0014A**PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

**NOTES:**

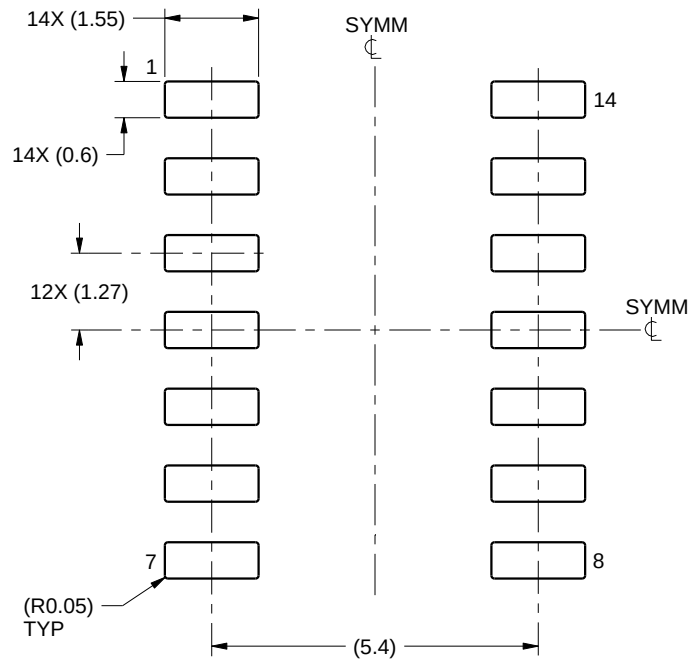
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

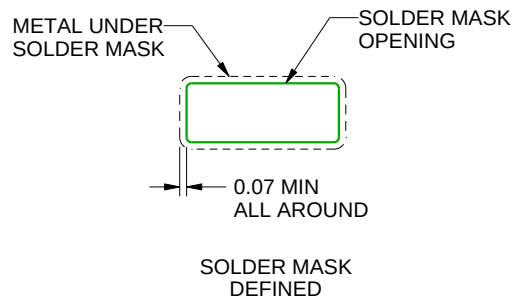
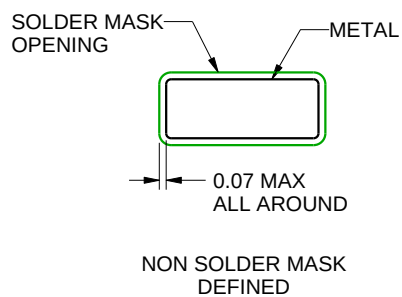
D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

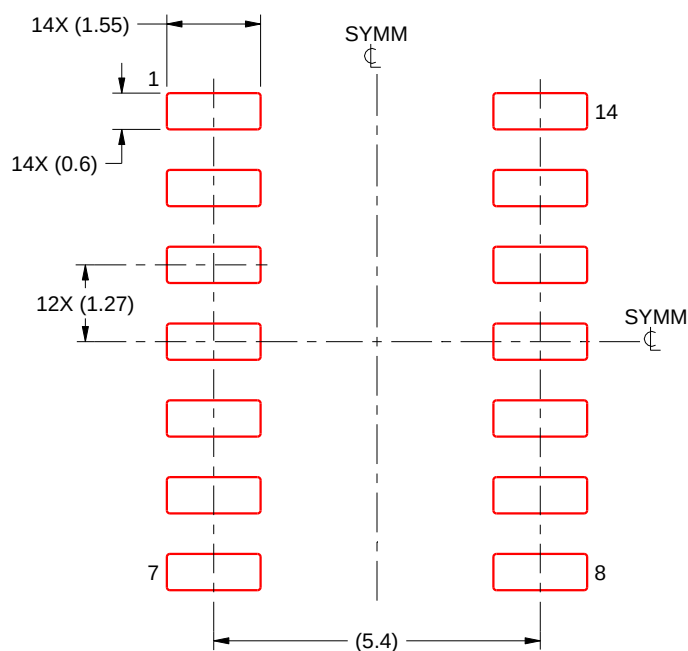
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

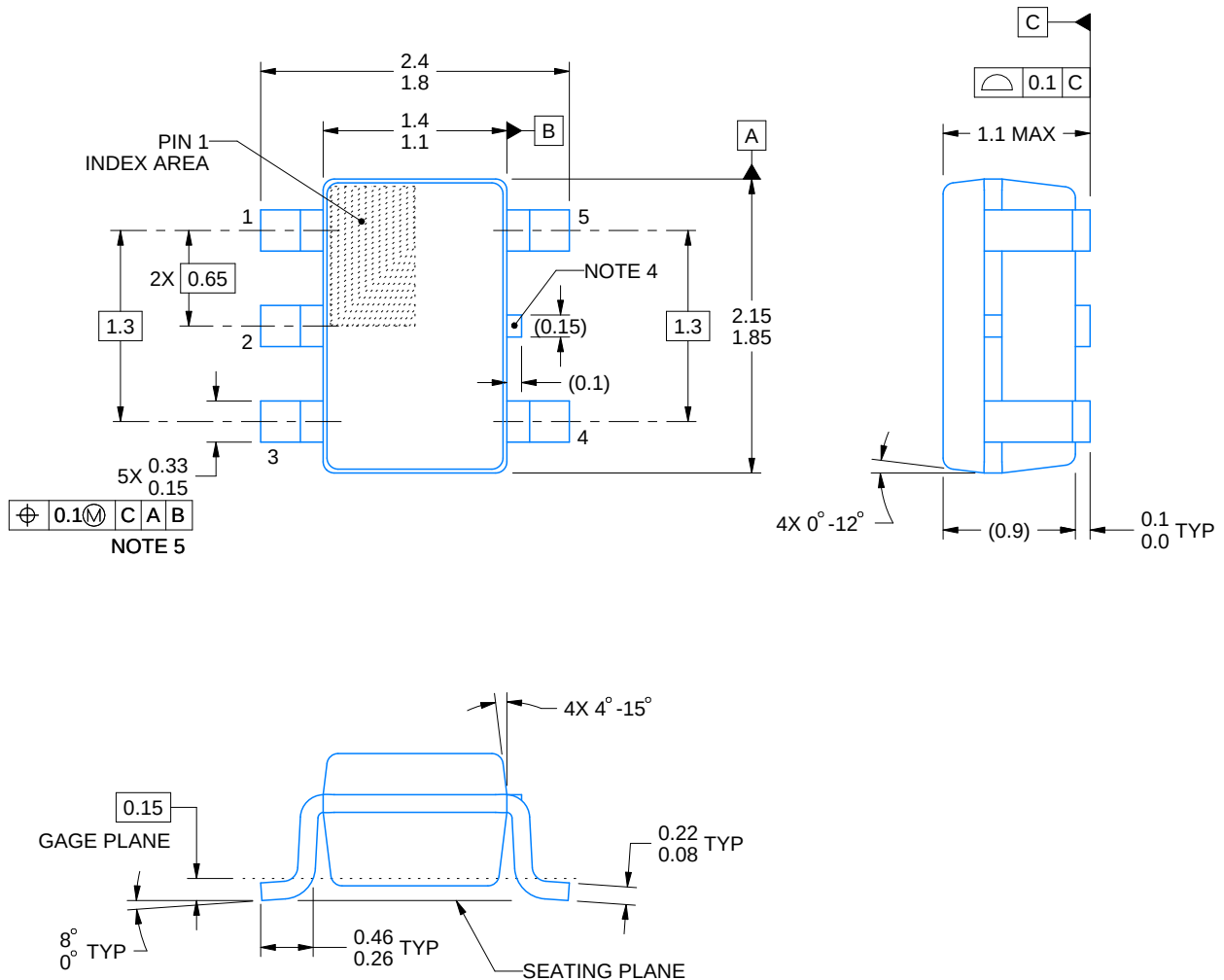


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

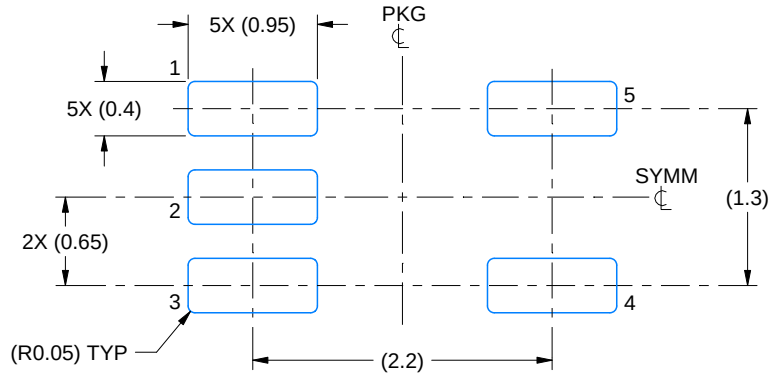
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



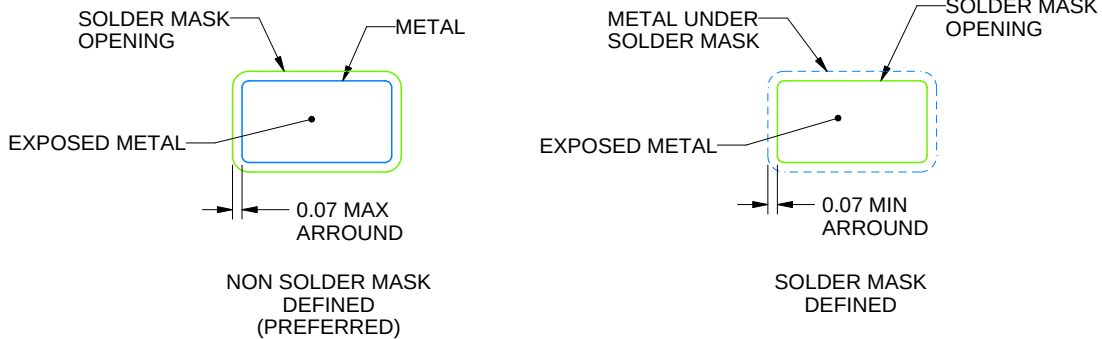
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

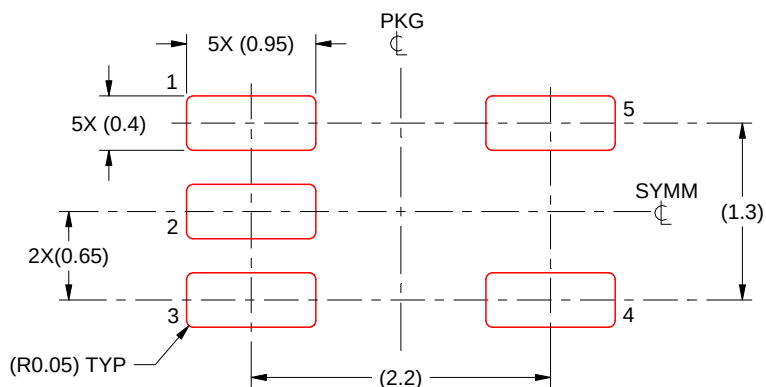


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

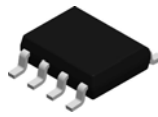


SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 THICK STENCIL
 SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

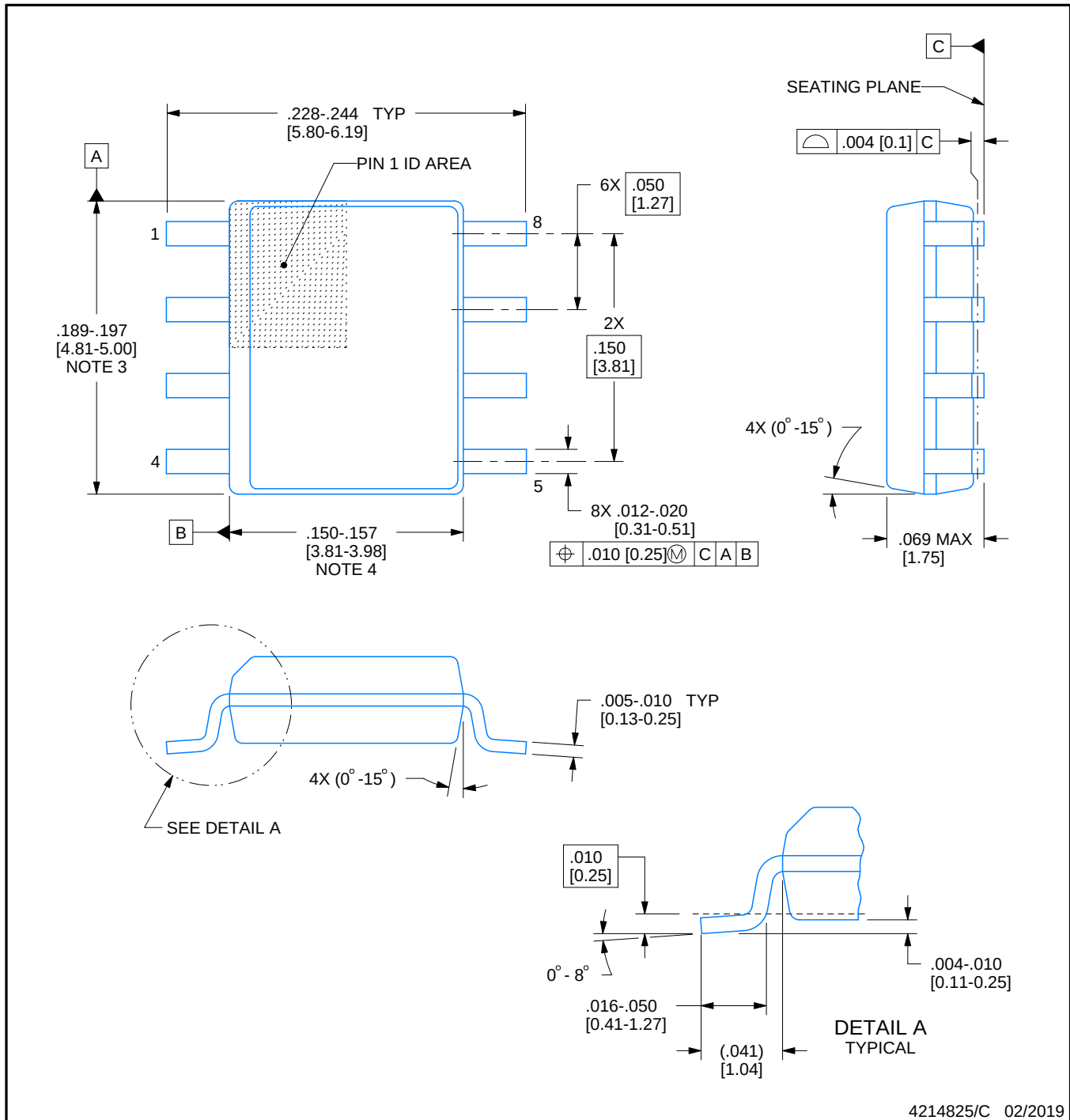


D0008A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4214825/C 02/2019

NOTES:

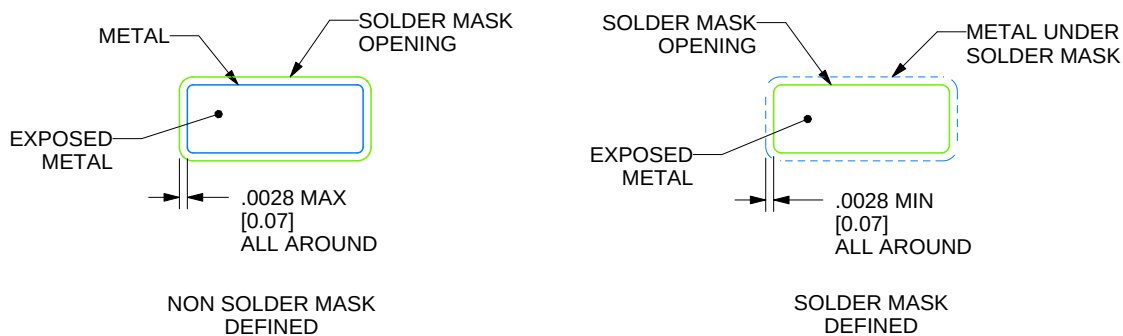
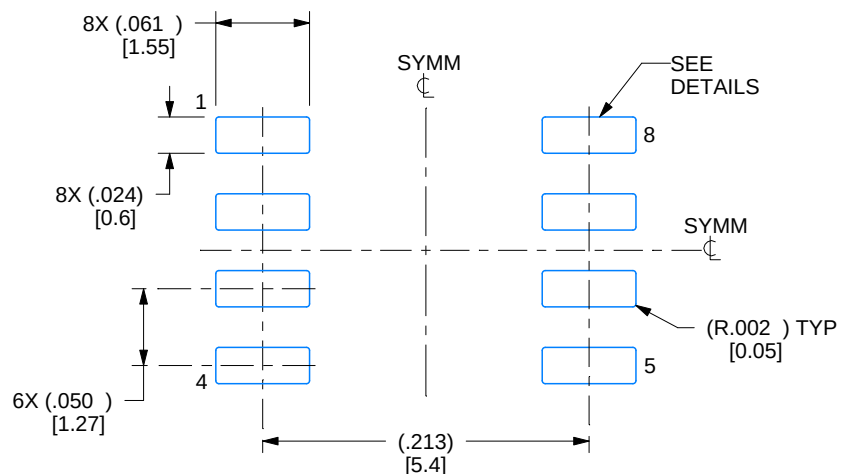
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

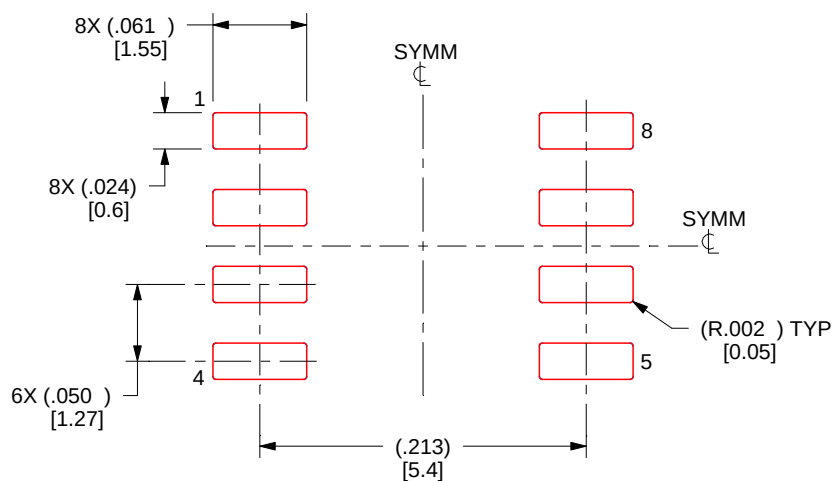
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

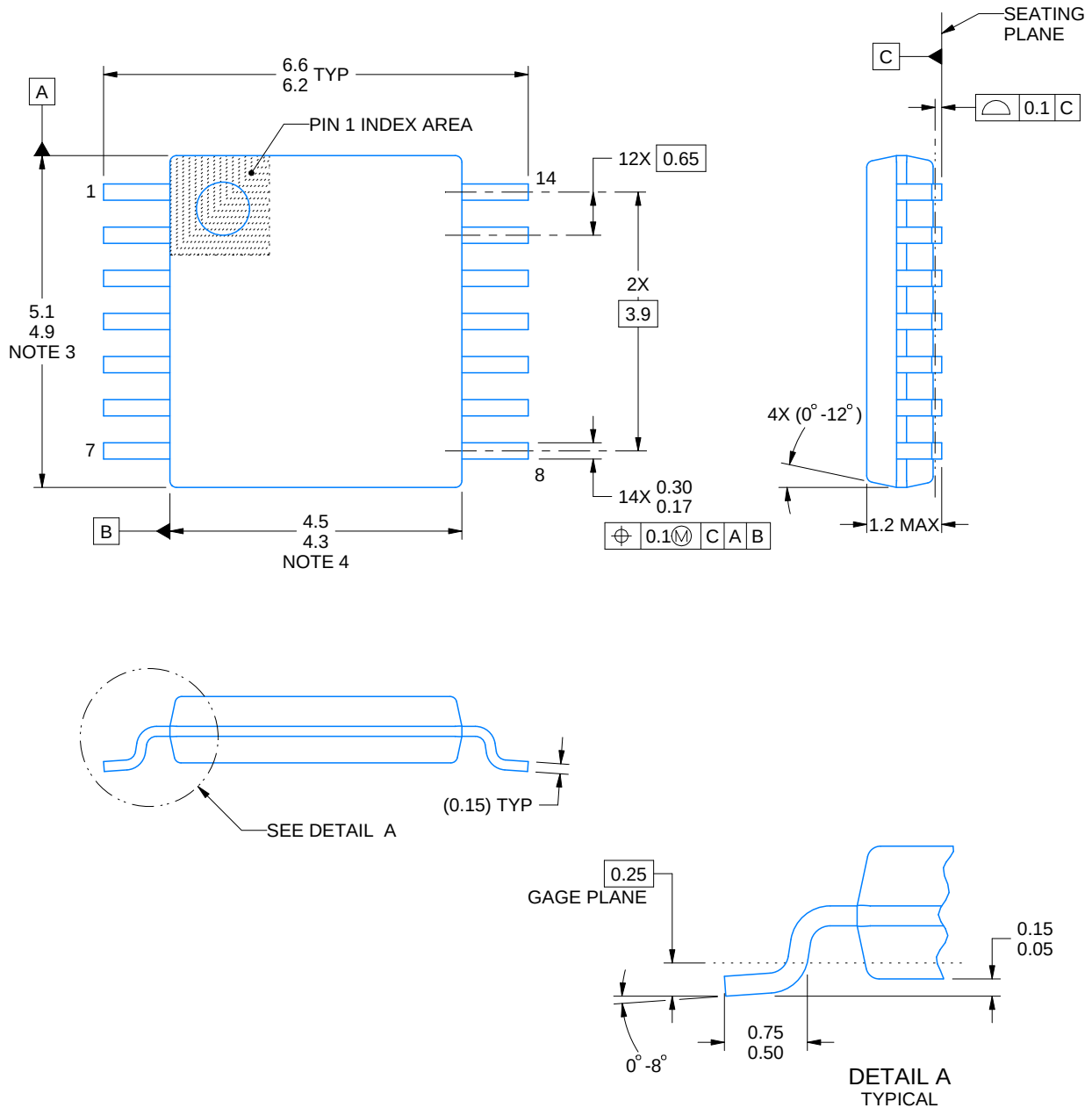
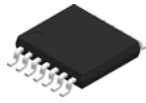


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



4220202/B 12/2023

NOTES:

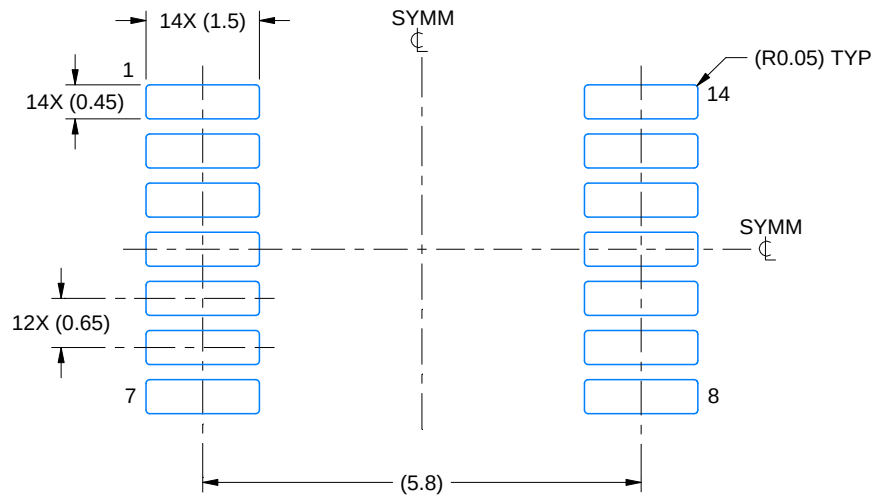
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

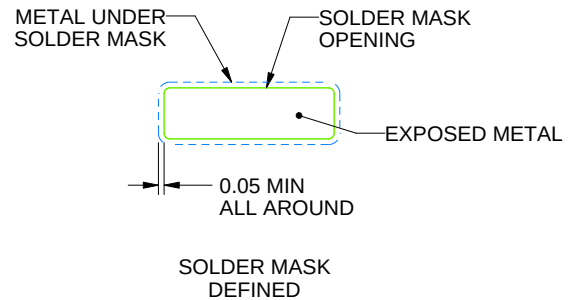
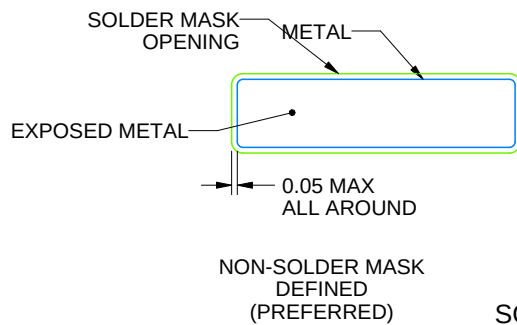
PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

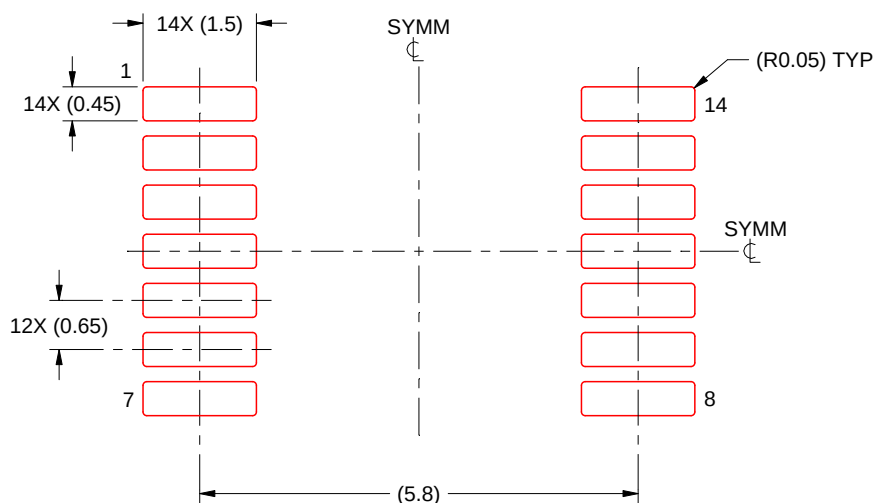
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

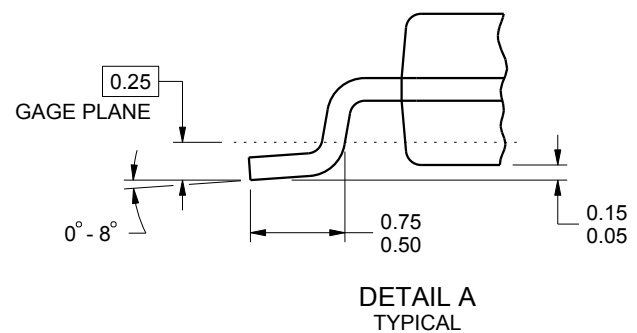
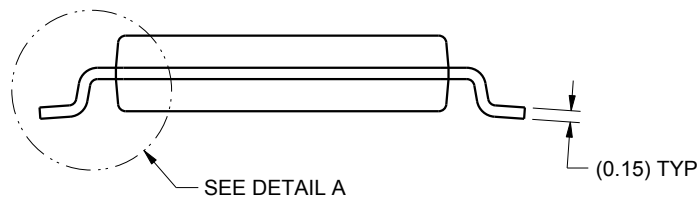
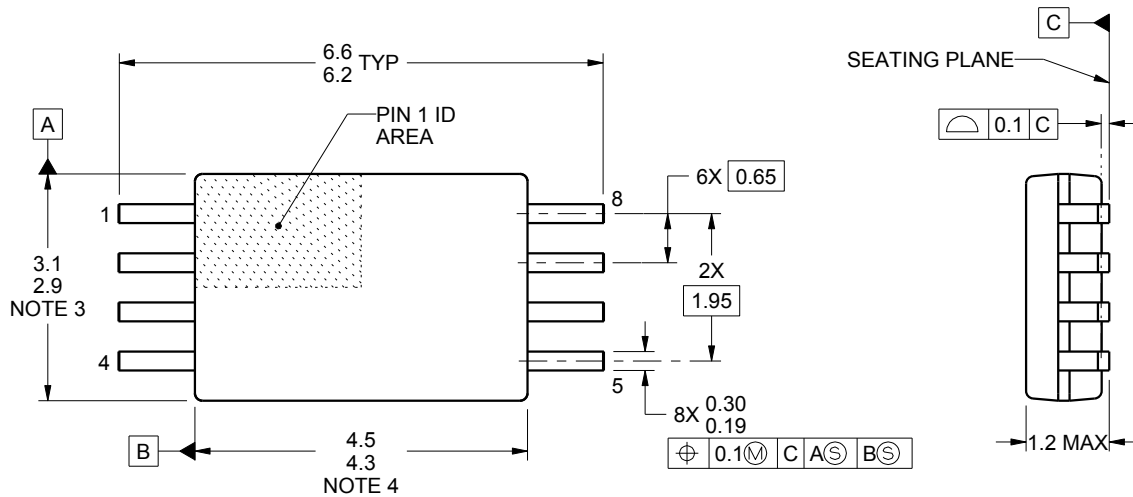
PW0008A



PACKAGE OUTLINE

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4221848/A 02/2015

NOTES:

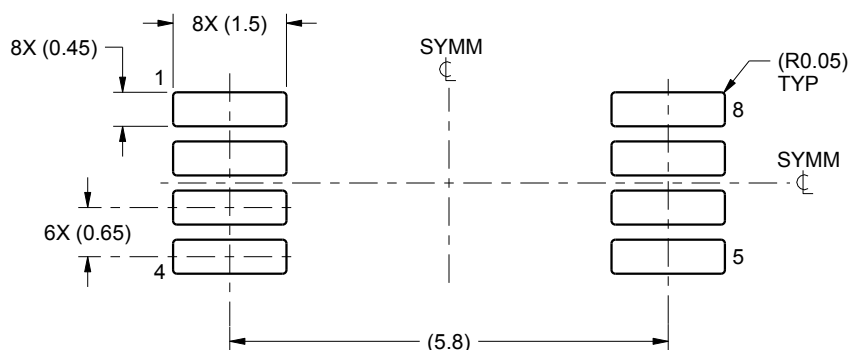
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

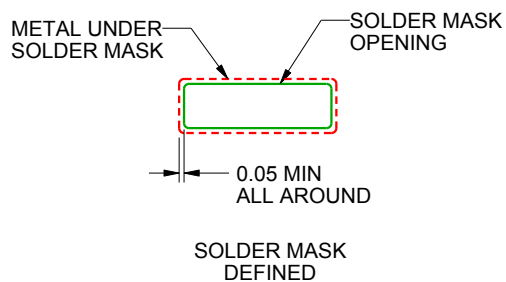
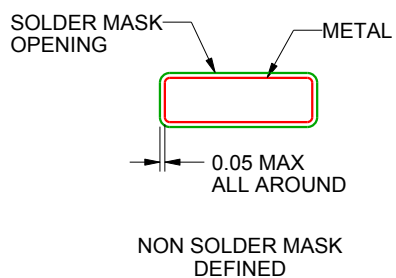
PW0008A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

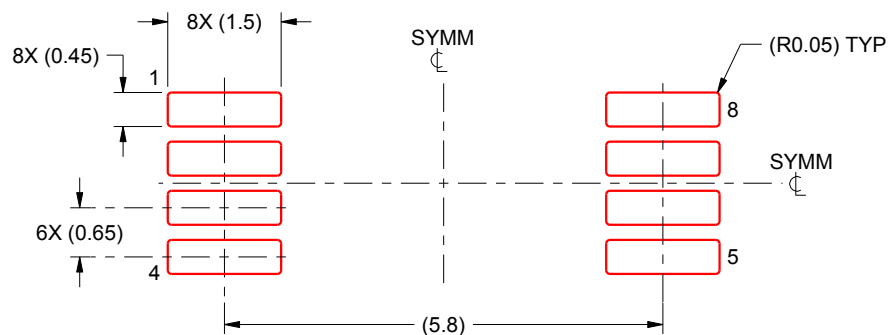
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0008A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月